Topm, n nava Alfrand of und Son Stacks

согласовано

руководитель

государственной приемки

Испекси и.и.попков

"15" // 1989 г.

утверхдан Директор икб "дейтон" С.в.якубовский

"20" 12 1989r.

МИКРОСХЕМИ ИНТЕГРАЛЬНИЕ

КАІБІБХИ 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

АЛБК 431432.013 ТУ-ЛУ

СОГЛАСОВАНО ГЛАВНИЙ ИНЖЕНЕР НИИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Тоше A:А:ПОПОВ
"3" И 1989г:

✓ главний инхенер
Завода "ангстрем"

а:а:вологов "14" // 1989г: /главный инженер нии точной технологии

1900 р. а. платонов "26" 10 1989г.

p6052

ок п

rp: 005/020949 or 15.01.90

УДК -

УТВЕРЖДЕНИ

РРУППА Э 25

АДБК: 431432.013 ТУ-ЛУ

"20" /2 1989 r.

СОГЛАСОВАНИ С ОСНОВНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

" 3 " 11 1989r.

С БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ по стандартизации

" 20 " 12 1989r:

TY II-89

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ KAI5I5XM2 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДБК: 431432:013 ТУ ( ВВЕДЕНН ВПЕРВИЕ )

срок действия с 20.01, 90 <sub>г</sub>.

8 60 SZ

HACTORNIE TEXHUTECKUE VCЛОВИЯ (TV) РАСПРОСТРАНИВТСЯ НА
МИКРОСХЕМИ ИНТЕГРАЛЬНИЕ СЕРИЙ WALSIS, (ДАЙВЕ МИКРОСХЕМИ), РАЗРАБОТАННИЕ НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО КРИСТАЛЛА ( БК) KATSISXM2,
ИЗГОТАВЛИВАЕМИЕ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА:

КЛИНАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХА, КАТЕГОРИЯ 5.1 ПО ГОСТ 15150:

МИКРОСХЕНИ, ВИПУСКАЕНИЕ ПО НАСТОЯЩИМ ТУ, ДОЛІНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 18725. И ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ НАСТОЯЩИХ ТУ.

МИКРОСХЕЙН, ВКИПЧЕННИЕ В НАСТОЯЩИЕ ТУ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКИЕ В В БЕСКОРПУСНОМ ИСПОЛИВНИИ НА ОВЩЕЙ ПЛАСТИНЕ В СООТВЕТСТВИИ С С ТРЕБОВАНЙЯМИ РД 11 0723.

требования к микросхемам, поставляемим по ра 11 0723 изложени в приложении и в картак заказа:

HARPOGXEMA B KOPNYCE 4223.64-1 FOCT 20:39:465 HE PAGNPOCTPAHRETCH:

TY BRIDGART HACTORQUE TY N KAPTH BAKABA HA KOHKPETHHE

#### RUHERORON ENMED :I

териини и определения — по гост 17021, гост 19480, ост н 0224:

перечень ссылочных нормативно-технических документов приведен в разделе 10:

1:1: КЛАССИФИКАЦИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ;

I.I.I. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОВНАЧЕНИЙ МИКРО-СХИМ ПО ОСТ 11 073.915.

di	7 40	4.281.0428.20		2.00			AJIBK.4	31432.0	тэ ту		W
1	Изи Лист	Nº dokun	i di a	1010	1		*				
X	Разраб	Запевина	300/2		Marron	Avenu	rement	альные	llom	Aucm	Aucm06
8	TPO6+	Корсетов Петров Дементива	21,000	25.2	AMERICA CO		生生人的中国		A I	2	63
S	T. KOHIP	Петров -	2/1	3.590	1677	MALC	ISXM2				
es.	H KOHTP	Hemeumethe	Section?	196	Теч	HIMIACK	ие усл	oava	Sile on the	* * ***	
3	Ymb 1	Баранов	Steel	860				De Austria	F		

IN 2: THE BAK YKASAH B TAGA IN

III:3; THIN (TUROHOMNHAMH) HOCTABLISHMIX MURTOCKEM YKASAHH B TAGL:16:

1:1:4: Примерн овозначения микросхем при заказе и в конструкторской документации:

MUKPOCKENA KATSISKM2-XXX

AABK 431432.013 TV

KAPTA SAKASA 3.414.XXX A.

946.45 noon Moon w dama 83am web.№ Web n you Moon w day

HOR DANGE JOUR MAY

AUGH. 431432.013 TY

TABANIA 18.	O E O 3 H A VEHNE	un3.480.311 51	г. га группа г код типов г окп	I   63 3124 3704   1
	В НОРИАЛЬНЫХ  НИЦА ИЗМЕРЕНИЯ;  ЕДНЕЕ ! МОЦНОСТБ  ЕЛЯ — ! МОТРЕБ— ДЕРЖИ! ЛЕНИЯ НА  ВЕН— ! ВЕНТЕЛЬ,  ЛЬ   РСС  ЗМЕРЯ—! мВт  СЯ В !  ПОЧКЕ !  НТЕЛЕЙ!	5   I,3   UM3.480.311	ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. ТА   ЧЕНИЕ 10 БОЗНАЧЕНИЕ   ТКОЛИЧЕСТВО   ГР   10 БРАЗЦОВ   19 ЛЕМЕНТОВ   ТИ   1 ВИДА   18 СХЕМЕ   1   1 ВИДА   19 ЛЕКТРИЧЕС-   1 КОЙ .   1	1.348.071 42 1 23550 1 1
B3axunbwunf dxón nognu dara		4,0 0,5 I IO	HKE TABA-IYC JOBHOE OBOSHAYEHUE YEPTETA   KOPHYCA	FY   4223.64-I ALNOHHUE HAPAMETPN,OBO3H ME SJEKTPHYECKON CXEMU
6692 Well 14m 90	УСЛОВНОЕ   ОСНОВНОЕ   ОБОЗНАЧЕ—   ФУПКЦИО—   НИЕ МИКРО   НАЛЬНОЕ   СХЕМЫ   НАЗНАЧЕНИЕ	KAISISXM21UNOHAJBHARI IUMPPOBAR I IUMPPUUA	УСЛОВНОЕ 10БОЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕ-1РИТНОГО ЧЕРТ НИБ ИИКРО! СХЕМЫ	KAISISXM2IUNO.073.242 FY IIIPMEYAHUE: KJACCUФUKAUNOHHUE

		1-1KOA 8-10KB 11-1 10-1	163 3124	163 3124	63 3124   5771			
	16.	KO IN 4 EC		14800 1 1	[2100 ] I			
	ТАБЛИЦА	   HOMEP	93 Y13.480.   075 MJ	31913.480.1 1076. NJ	93 VI3.480.			
		ОБОЗНА ЧЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИ ЧЕСКО П		AIVI3.480.076 931VI3.480.1				
<u>272</u>		OBOSHAYEHNE 10 KAPTU SAKASA 10	3.414.407 A!YI3.480.075	3.414.408 AD	3.414.409 Д1У13.480.077			
भ् <i>वेडका. तरावेत. प वेदा</i>			1413.480.3091YI	143.480.3101YI	UN3:480.308[XI			
Ta B3amunewune "			IKOHTPOLLEP VIPA-I IBJEHMA KAABMATY-IU IPON IIYJETA BUPA-I IBOTKU CUTHAJOB I	КОНТРОЛЛЕР ОЗУ ИВРЕФИРИЙНОГО ІЦ ПРОЦЕССОРА	IKOHTPOJJEP IVIPABJEHNG 039 IU IUEHTPAJSHOFO IIIPOUECCOPA			
Madnuda Jung 14 iii		VCJOBHOE OBOSHAYEHNE MWKPOCXEMB	KAISISXM2-00111	KAISISXM2-0021	KAISI5X#2-003			
UHB Nº 000	BMJ/UCT, Nº	₹докум. Под/				1432.013 TY	Форми	14 2177.44

2.1.1. МИКРОСХЕМЫ ИЗГОТАВЛИВАВТСЯ ПО КОМПЛЕКТАМ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 18, 16.
ОБЩИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ \*
МИКРОСХЕМ ПРИВЕДЕНЫ НА ЧЕРТЕЖЕ ЩИО. 073. 242 ГЧ.

2.1.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ ВНЕШНЕГО ВИДА ЦИО. 348:071 Д2
ПРИЛАГАЕТСЯ К ТУ.

2.I.3. MACCA MUKPOCXEMU HE BOAEE 5r.

2.1.4. ВЕЛИЧИНА РАСТЯГИВАЮЩЕЙ СИЛИ НЕ БОЛЕЕ 2,5 Н (0,25 КГС), МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ КОРПУСА ДО МЕСТА ИЗГИБА I им, РАДИУС ИЗГИБА 2 С + С (С-ТОЛЩИНА ВЫВОДА).

2.1.5. ТЕМПЕРАТУРА ПАЙКИ ( 235±5 )°С, РАССТОЯНИЕ ОТ КОРПУСА до места пайки 1,5 мм, продолжительнсть пайки 2+0,5 с.

МИКРОСХЕМЫ ДОЛІНЫ ВЫДЕРІИВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕПЛА, ВОЗНИКШЕГО
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПАЙКИ (260±5)°С:

ЧИСЛО ДОПУСКАЕМЫХ ПЕРЕПАЕК ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

монтакных (сворочных) операций) - о

АДБК. 431432.013 ТУ

NUCT 5

5

POPMO 50 NO FOCT 2.106-68

DOPMOM 44

2.1.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С НАЗНАЧЕНИЕМ И НУМЕРАЦИЕМ ВИВОДОВ ПРИВЕДЕНЫ НА ЧЕРТЕЖАХ, ОБОЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ УКАЗАНЫ В ТАБЛ.1а, 16.

нумерация и назначение внешних выводов микросхем должны соответствовать электрической схеме, прилагаемой к карте заказа:

2.1.7. МИКРОСХЕМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРУДНОГОРОЧИМИ.

аварийный электрический режим  $V_{IH} > V_{CC}$  + 0.3 в.

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ Параметрам и режимам

2.2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ, РАЗРАБОТАННЫХ

НА ОСНОВЕ БК ПРИВЕДЕНЫ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

МИКРОСХЕМЫ ДОЛІНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАЦИИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В КАРТЕ ЗАКАЗА, В РЕХИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩИХ ТУ, ПРИ ЭТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ ДОЛІНЫ ОСТАВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ТАБЛ.2 ТУ И КАРТЕ ЗАКАЗА.

2.2.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ В ТЕЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ НАРАБОТКИ В ПРЕДЕЛАХ ВРЕМЕНИ, РАВНОГО СРОКУ СОХРАНЯЕМОСТИ, ПРИ-ВЕДЕНЫ В ТАБЛ.2.

АДБК. 431432.013 ТУ

11007

PODMO 50 NO POCT 2.105-68

COOMON AY

2.2.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
СОХРАНЯЕМОСТИ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОСХЕМ, РАЗРАБОТАЙНЫХ НА ОСНОВЕ БК, ПРИВЕДЕНЫ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

2:2:4: ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ:3:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИЙОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ МИКРОСХЕМ ПРИВЕДЕНЫ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

2.2.5. НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ МИКРОСХЕМ  $V_{CC}$  = 5 в.

ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНОГО ±10 %:

2.2.6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ НА МИКРОСХЕМУ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ И ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ:

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ: ПОДАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ; ПОДАЮТСЯ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ:

ПРИ ВЫКЛОЧЕНИИ: СНИМА ОТСЯ ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ; СНИМАЕТСЯ НАПРЯЖЕ-

RNHATNI BNH

АДБК. 431432.013 ТУ

VIUC

BMJUCT Nº BOKYM. NOON. LLAND PODMO 50. NO FOCT 2.106-68

ODDMam 44

2.3.ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ

при механических воздействиях

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО - ГОСТ 18725 В

TOM YMCHE:

линейное ускорение 5000 (500) м/с<sup>2</sup> (д ):

2.4: требования к устойчивости

при климатических воздействиях

2:4:1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ - ПО ГОСТ 18725 В ТОМ

числе: пониженная равочая температура среды - 10°C;

повишенная рабочая температура среди 70%;

повишенная предельная температура среди 85°С;

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ ОТ МИНУС 60°C ДО 85°C.

2.5. TPEBOBAHUS K HAJETHOCTU

2.5.1. НАРАБОТКА МИКРОСХЕМ 50000ч . А В ОБЛЕГЧЕННОМ РЕЖИМЕ

 $\mathcal{V}_{cc}$  =5 в ± 5 %. виходних токах  $Z_o$  не волее 50 % от

ЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В ТАБЛ:4 - 60000ч.

2.5.2. NHTEHCUBHOCTS OTKASOB B TEVENUE HAPAGOTKU HE

БОЛЕЕ I·10-6 1/4:

2.5.3. ГАММА ПРОЦЕНТНИЙ СРОК СОХРАНЯЕМОСТИ 10 ЛЕТ.

**АЛБК. 431432. ОТЗ ТУ** 

8

ЗМ ЛИСТ, Nº ЙОКУМ. ПООП. Цага

WINDMO 50 NO FOCT 2.105-68

DODMOM 45

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА, Г ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, І РЕХИМ ИЗМЕРЕНИЯ І	обозначе- ниё	I HE	r he	TENNE-INPUME- IPATYPAJ VAHNE I *C I
ВИХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ! НИЗКОРО УРОВНЯ. В ! ПРИ Vec = 5 B±5% !  Ток = 1,6 ма !	Vox	1 1 - 1	1 1,0,5 1	125±10 1 1 -10   1 1 70   1 1   1
виходное напряжение ! високого уровня, в ! при <i>Vcc</i> = 5 B± 5% . <i>Тон</i> = 0,4 мл !	Vон	2000	- Sec. 1016	25±10    '-10    70
ток потребления, иа ! при <i>Vec</i> = 5 B ± 5% !	Icc	  - 	0,8   I,0 	125±10 1 1 -10 ! ! 70 1
ток утечки на входе и низкого и высокого уровня, ика и при $Vcc = 5$ в $\pm 5\%$	Inin Inih	 	1 5 1 10 1 10	125±10
ВИХОДНОЙ ТОК В СОСТОЯ— НИИ "ВИКЛОЧЕНО" ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ВИСОКОГО И НИЗКОГО УРОВНЯ, ЖКА ПРИ <i>Vcc</i> = 5B ± 5%	Догн Дожк		27.745	f ! 125±10 ! I-I0 ! ! 70 !
при Вес = 58 ± 5%  время задержки, но при Вес = 5 в ± 5%	Ld			

примечания: г. режими измерения электрических параметров приведени в табл. 5.

\*: КОНКРЕТНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРХКИ ПРИВОДЯТСЯ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

В КАРТЕ ЗАКАЗА МОГУТ БИТЬ УСТАНОВЛЕНИ ДРУГИЕ Динамические параметры с указанием метода контроля.

**АДБК. 431432.013** ТУ

110<u>C1</u> 9

PODMA 50 NO MOCT 2.106-58

3.1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА В ПРО-ЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА - ПО ГОСТ 18725.

OTEPAKOBOTHNE UCHNTAHUS NO FOCT 18725, B COOTBETCTBUU

- з:2. ПАВИЛА ПРИЕМКИ
- 3.2.1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПО ГОСТ 18725 И ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПУНКТЕ.
- 3.2.2. ИСПИТАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ПРОЧНОСТИ ВНЕШНИХ ВЫВОДОВ МИКРО-СХЕМ ГРУПП К-7, П-4 НЕ ПРОВОДЯТ:
- 3.2.3. ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГРУПП К-7, П-4 И ИСПЫТАНИЯ НА ВИБРОПРОЧНОСТЬ И ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ ГРУПП К-9, П-5 МИКРОСХЕМ НЕ ПРОВОДЯТ: ВМЕСТО ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРОВОДЯТ ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА (КРАТКО-ВРЕМЕННОЕ):

АДБК. 431432.013 ТУ

- 3.2.4. ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ГРУППЕ С-І ПРИЕМОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ДЕФЕКТ-
- 3:2:5: для испытаний по группе С-3 приемочный уровень дефект-
- 3.2.6. ОБЪЕМ ВИБОРКИ ДЛЯ ГРУППИ ИСПИТАНИЙ K-II П = 19 MT.,
- 3.2.7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ, УКАЗА-ННОМУ В ТУ П.3.3.4.2.
- 3.2.8. ВРЕМЯ ВЫДЕРІКИ МИКРОСХЕМ ПЕРЕД ПРИЕМО-СДАТОЧНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ 24 ЧАС.
  - з:з: методы контроля
  - 3.3.1. методы контроля-по гост 18725 . И ост 11 073:013.
  - з.з.г. общие положения
- 3.3.2.1. СХЕМИ ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМ ПРИ ИСПИТАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ПОД ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМИ ВИДЕРЖКИ В ПРОЦЕССЕ ИСПИТАНИЙ И ПАРАМЕТРИ КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ ПРИВЕДЕНИ НА РИС.1.2,10,11.

ОХЕМИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИВЕДЕНИ НА РИС:3-7:

АЛБК.43I432.0I3 TУ

## таблица з

наименование парамет- ров режима, единица	- ОБОЗНАЧЕ-	White Street	<b>IA</b>	I INPUMEANNE
RUNACEMENTAL	I HUE	i he I meheb	HE I BOJEE I	
напряжение питания, в	i Vec	l 4,75	l 5,25 l	
входное напряжение низкого уровня, в	! ! Vzh !	l 0,2 L	  - 	
входное напряжение вноокого уровня, в	! ! <i>V</i> IН		5,5	

On noon u data B3am.uHBMUHB. YUGI. Noon. u dar

<u>адык.431432.013</u> ту

12

MODER SO OF COCT 2105-5

POPMAM A

Э:3:2:2: ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ, ИХ НОРМЫ, УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ:5:

И КАРТАХ ЗАКАЗА:

СОСТАВ ПАРАМЕТРОВ ПО КАХДОМУ ВИДУ ИСПЫТАНИЙ ПРИВЕДЕН В ТАБЛ:6

И В КАРТАХ ЗАКАЗА:

доверительная вероятность погрешности измерения 0,997;

Э.Э.2.Э. ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ВОЭДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ, АТМОСФЕРНОГО ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ,
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ( КРАТКОВРЕМЕННОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ),
ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ, ОДИНОЧНЫХ И МНОГОКРАТНЫХ УДАРОВ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ УСТАНОВКУ И КРЕПЛЕНИЕ МИКРОСХЕМ ПРОИЗВОДЯТ
В СООТВЕТСТВИИ С РИС.8, ФОРМОВКА ВИВОДОВ В СООТВЕТСТВИЙ С РИС.9.

ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

СРЕДЫ, БЕЗОТКАЗНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ БЕЗ

РАСПАЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТАКТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ПРИ ЭТОМ

ВИВОДИ МИКРОСХЕМ НЕ ФОРМУЮТСЯ;

ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ОДИНОЧНЫЕ И МНОГОКРАТНЫЕ УДАРЫ, ЛИНЕЙНЫЕ
НАГРУЗКИ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСКОРЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РИС:8

АДБК.43I432.0I3 TУ

13

Onomam A

MUJUCT Nº BOKYM. 1700 n. 11grd PODMO. 50. np. 170CT 2106 при испытаниях на воздействие изменения температуры среды атмосферного повышенного давления микросхемы помещают в камеры так, чтобы они не касались друг друга:

3.3.3. ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ

\* 3.3.3.1. ПРОВЕРКУ ОБЩЕГО ВИДА, ГАБАРИТНЫХ, УСТАНОВОЧНЫХ И
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 404-1

OCT II 073:013 HA COOTBETCTBUE MUO:073:242 ГЧ:

погрешность измерения не волее + 0,05 мм;

3:3:3:2: ПРОВЕРКУ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 405-1:3

ОСТ II 073:013: ПРОВЕРКУ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ПРОВОДЯТ

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 16<sup>X</sup>:

3.3;3:3 ПРОВЕРКУ MACCU MUKPOCXEM ПРОВОДЯТ ПО METOДУ 406-1 OCT II 073:013:

3.3.3,4. ПРОВЕРКУ ПРОЧНОСТИ ВНЕШНИХ ВИВОДОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 109-1 ОСТ 11 073.013, РАСТЯГИВАВЩАЯ СИЛА 2,5 Н (0.25 Krc):

ПРОВЕРКУ ПРОЧНОСТИ ВНЕШНИХ ВЫВОДОВ НА ИЗГИБ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ IIO-3 ОСТ II 073:013. РАДИУС ИЗГИБА 2C+C (С-ТОЛЩИНА ВЫВОДА)

3.3.3.5. ПРОВЕРКУ ВЫВОДОВ НА СЛОСОБНОСТЬ К ПАЙКЕ ПРОВОДЯТ
ПО МЕТОДУ 402-I ОСТ II 073:013.

**ДДБК.431432.013** ТУ

SUE.

PODMA 50 NO FOCT 2.106-68

PODMOM A

УСКОРЕННОЕ СТАРЕНИЕ ПО МЕТОДУ З.

3.3.3.6. ПРОВЕРКУ ВЫВОДОВ НА ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ПРИ ПАЙКЕ ПРОВОдят по методу 403-1 ост 11 073.013

3.3.3.7. ПРОВЕРКУ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ МИКРОСХЕМ ПРОВОДЯТ
ПО МЕТОДУ 208-2 ОСТ II 073.013 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ЛАКОМ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ 40°C БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ:

э:э:3:8: проверку нумерации внешних выводов микросхем сов- \*
мещают с проверкой электрических параметров:

Э;Э:Э:Э: ИСПЫТАНИЕ МИКРОСХЕМ НА СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ ГОРЕНИЕ
ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 410-1 ОСТ 11 073;013;

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВЕДЕНА НА РИС:10:

3:3:3:10: MCHWTAHUE MUKPOCXEM HA FOPDVECTS ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ
410-2 OCT II 073:013: ВРЕМЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ
К МИРОСХЕМЕ 30 c:

АДБК. 431432.013 ТУ

VIUC

3.3.4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ГОК.

И ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГОН МИКРОСХЕМЫ ПРОВОДЯТ

ПО ГОСТ 18683.1 В РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ.5, ПО

СХЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ НА РИС.3 СОГЛАСНО ТЕСТАМ, ПРИВЕДЕННЫМ

В КАРТЕ ЗАКАЗА:

при этом, проводится функциональный контроль до теста, указанного в карте заказа, после чего проводится измерение в име Гол., Гон. при наличии на выводах резисторов, отключение резисторов от измеряемого вывода проводится только в момент измерения Гол., Гон:

3.3.4.3. ФУНКЦИОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ МИКРОСХЕМОЙ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВХОДНЫХ КОМБИНАЦИЙ И ИЗМЕРЕНИЯ
ПРИ ЭТОМ НА СООТВЕТСТВУДЦИХ ВИВОДАХ ТОХ И ТОН : ИЗМЕРЕНИЕ
ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДУ 3:1 ОСТ 11 073:944 В РЕЖИМАХ И
УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ:5 ПО СХЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ НА
РИС:6, СОГЛАСНО ТЕСТАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ ВЫВОДОВ В РЕЖИМЕ "ВХОД-ВЫХОД" С

АЛБК. 431432.013 ТУ

AUCT

BMJUCT Nº OOKYM. NOON. Uara

WARMO 50 AD FOCT 2.105-68

CODMOM144

Nº MOJ MOJN. U DOTO B30M CHBNUHB. ONON NOON U DOTO

третьим состоянием, что указывается в карте заказа, между этими выводами и Vec может подключаться резистор R=3.3 ком  $\pm$  10%:

3:3:4:4: ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ДСС ПРОВОДЯТ ПО

ГОСТ 18683:1 В РЕХИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ:5, ПО СХЕ
МЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ НА РИС:4 СОГЛАСНО ТЕСТАМ ПРИВЕДЕННЫМ

В КАРТЕ ЗАКАЗА.

при этом проводится функциональный контроль до теста, УКАЗАННОГО В КАРТЕ ЗАКАЗА: ПРИ НАЛИЧИИ РЕЗИСТОРОВ , ПОД-КЛЮЧЕННЫХ К ВИВОДАМ МИКРОСХЕМЫ, РЕЗИСТОРЫ ОТКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ВИВОДОВ НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ АКТИВНОГО ВИХОДА И УКАЗАННЫХ В карте заказа: затем проводится измерение тока потребления Ісс 3:3:4:5: ИЗМЕРЕНИЕ ВХОДНОГО ТОКА УТЕЧКИ ПРИ НАПРЯЖЕНИЯХ низкого и высокого уровней Іліл . Ілтн по кахдому входу проводят по методу 4:10 ост 11 073:944 в В РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 5, ПО СХЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИ-ВЕДЕННОЙ НА РИС.5, СОГЛАСНО ТЕСТАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В КАРТЕ ЗАКАЗА: 3.3.4.6. ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНОГО ТОКА НИЗКОГО УРОВНЯ И ВЫХОДНОГО тока высокого уровня Іода. Іоди в состоянии " выключено" проводят по методу 4:13 ост 11 073:944 В РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 5 ПО СХЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ НА РИС. 5,

алык. 43I432.0I3 ТУ

СОГЛАСНО ТЕСТАМ ПРИВЕДЕННИИ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

3:3:4:7: ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРІКИ Zd ПРОВОДЯТ ПО ГОСТ 18683:2 В РЕЖИМАХ И УСЛОВИЯХ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ:5, ПО СХЕМЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИВЕДЕННОЙ НА РИС:7:

. 3:3:4:8: МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, НОРМЫ И РЕ-

3:3:5: проверка устойчивости при механических воздействиях

3:3.5.1. ИСПЫТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ОДИНОЧНЫХ УДАРОВ ПРОВОДЯТ по методу 106-1 ост 11 073:013 по  $1\overline{1}$ 1 степени жесткости.

3.3.5.2. ИСПЫТАНИЯ Н ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОГОКРАТНЫХ УДАРОВ ПРОВОДЯТ
по методу 104-1 ост 11 073:013 по 15 степени жесткости:

3.3.5.3. ИСПИТАНИЕ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК ПРОВОДЯТ по методу 107-1 ост 11 073.013 по ут степени жесткости:

AJIBK.431432.013 TY

VIUCT

3.3.6. ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

3.3.6.1. NCHNTAHNE HA BOSHENCTBNE HPN HOHNXEHHON PAGOVEN
TEMHEPATYPH CPEHH HPOBOHRT HO METOHY 203-1 OCT II 073.013.

3.3.6.2. NCHNTAHNR HA BOSHENCTBNE HPN HOBENEHHON PAGOVEN TEMHEPATYPH CPEHH HPOBOHRT HO METOHY 201-1.1 NJN 201-2.1 OCT II 073.013.

CXEMA BKJDVEHUR HPN NCHNTAHNN HPNBEHEHA HA PNC.2.

3.3.6.3. ИСПИТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ К ИЗМЕНЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 205-І ОСТ ІІ 073.013.

количество циклов - 5.

ИСПИТАНИЕ НА ПОНИЖЕННУЮ ПРЕДЕЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ СРЕДИ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ПРОВОДЯТ, А СОВМЕЩАЮТ С ИСПИТАНИЕМ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРИ СРЕДИ.

3.3.6.4. ИСПИТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРНОГО ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 209-1 ОСТ 11 073.013.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИСПИТАНИИ ПРИВЕДЕНА НА РИС. II.

3.3.6.5. ИСПИТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
ВОЗДУХА (ДЛИТЕЛЬНОЕ) ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 207-2 ОСТ II 073.013.

3.3.6.6. ИСПЫТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРНОГО ПОВЫШЕННОГО ДА-ВЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 210-1 ОСТ 11 073.013.

АДБК.431432.013 ТУ

3.3.7.1. ИСПНТАНИЕ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 700-1

OCT II 073.013 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 70°С.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПРИВЕДЕНА НА РИС.2.

3.3.7.2. ИСПЫТАНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПО ГРУППЕ К-II ПРОВОДЯТ
ПО МЕТОДУ 700-2.2 ОСТ II 073.013. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ-КРИТЕРИЕВ ГОДНОСТИ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ 96, 168, 240, 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000 И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ
10000ч.ИСПЫТАНИЙ.СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПРИВЕДЕНА НА РИС.2

3.3.7.3. ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПО ГРУППЕ П-6 ПРОВОДЯТ
ПО МЕТОДУ 700-2.1 ОСТ 11.073.013 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 70 С В
ТЕЧЕНИИ 1000 Ч. СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ПРИВЕДЕНА НА РИС.2.

- 3.3.7.4. ИСПИТАНИЯ НА СОХРАНЯЕМОСТЬ ПРОВОДЯТ ПО ГОСТ 21493.
- з. з. в. проверка маркировки
- 3.3.8.1. ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА И СОДЕРХАНИЕ МАРКИРОВКИ ПРОВОДЯТ
  ПО МЕТОДУ 407-1 ОСТ 11 073.013.
- 3.3.8.2. ПРИ ПРОВЕРКЕ СТОЙКОСТИ МАРКИРОВКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯТЬ СПИРТО-БЕНЗИНОВУЮ СМЕСЬ (I:I) ГОСТ 25486.

**АДВК. 431432.013 ТУ** 

ВИД ИСПИТАНИЙ	IMETOД И УСЛОВИЯ ПРОВЕ- 1ДЕНИЯ ИСПИТАНИЙ ПО 10CT II 073,013	I I PNME TA HUI I
Г.ВИЗУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ КРИСТАЛЛОВ; СВОРКИ ПЕРЕД ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ	1 1405-1:1: УВЕЛИЧЕНИЕ 80 1405-1:1: УВЕЛИЧЕНИЕ 25	
2. ТЕРМООБРАБОТКА ДЛЯ СТАБИЛИЗА - НИИ ПАРАМЕТРОВ :		
перед герметизацией	. 48 4. 150°C	
после гериетизации	1 24 4. 70°C	1000
в испытание на воздействие	10Т МИНУС 60°С ДО 85°С,	
изменения температуры среды	ІНА КАЖДОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ	1
	ло пиклов	
4: ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ		
HAPAHETPOB	1 500-I	1 4 4 2
э. электротериотренировка	1 800-1, 125°C 85°C	! PMC.I
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПИТАНИЯ		
S.I. HPOBEPKA CTATUYECKUX		Para Angles
HAPAMETPOB HPM:		1 3 1
нормальных климатических		
УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРА-	500-1	
- N	1 203-I	HE -
ТУРЕ СРЕДЫ ПОВИЩЕННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕМИЕ-	2037	і проводят
PATYPE CPEAN	201-1.1	пповодит
5.2. ПРОВЕРКА ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРА-		
метров при нормальных		
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ	1 500-I	K A Same
5.3. ФУНКЦИОНАЛЬНИЯ КОНТРОЛЬ	I The Research of the State of	1
при повышенной рабочей тем-	1	ra
ПЕРАТУРЕ СРЕДЫ И НАИХУДШИХ		
СОЧЕТАНИЯХ ПИТАВЩИХ НАПРЯЖЕ		
HNA;		
У. КОНТРОЛЬ ВНЕШНЕГО ВИДА	1 405-I.3	

примечание. 1.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РПП ДОПУСКАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИСПИТАНИЙ. ДОПУСКАЕТСЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМКИ ПРОВОДИТЬ ЭТТ В ФОРСИРОВАННОМ РЕЖИМЕ:

э.э. 9. проверка упаковки

3.3.9.1. ИСПИТАНИЕ УПАКОВКИ - ПО МЕТОДАМ 404-2 И 209-4 гост 23088.

3.3.9.2. ИСПИТАНИЕ УПАКОВКИ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ СВОБОДНОМ ПА-ДЕНИИ ПРОВОДЯТ ПО МЕТОДУ 408-1.4 ГОСТ 23088.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНС — ПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.I. MAPKUPOBKA

MAPKUPOBKA - NO POCT 18725.

4.1.1. НА КАЖДОЙ МИКРОСХЕМЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАНЕСЕН РЕГИСТРАЦИОН-НЫЙ НОМЕР ИСПОЛНЕНИЯ (КАРТЫ ЗАКАЗА).

4.1.2. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ ОБОЗНА-ЧАЕТСЯ V.

- 4.2. **y** T A K O B K A
- 4.2.I. YHAKOBKA HO TOCT 18725.
- 4.2.2. МИКРОСХЕМЫ УПАКОВИВАЮТСЯ В ПОТРЕВИТЕЛЬСКУЮ ГРУППОВУЮ И ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ: УПАКОВКА ДОЛКНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ ОТ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА:
  - 4.3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
  - 4.3.1. TPAHCHOPTUPOBAHUE MUKPOCXEM NO FOCT 18725.
  - 4.3.2. XPAHEHNE NO FOCT 18725.

АДБК. 431432.013 ТУ

22

Doprama

USM JUCT, Nº ČOK YM. NOČIN. LLOTO SPORMO 50 DO POCT 2106 5:2. ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕ БОЛЕЕ 200 В.

5.3. УСТАНАВЛИВАТЬ И ИЗВЛЕКАТЬ МИКРОСХЕМИ ИЗ КОНТАКТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО . ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ.

5.4. PEXUM U YCJOBUR MOHTAXA MÜKPOCXEM B AHHAPATYPE - NO

5.5. МИКРОСХЕМЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ МОНТАХА В АППАРАТУРЕ МЕТОДОМ
ГРУППОВОП ПАПКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВИШЕ 265°С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
НЕ ВОЛЕЕ 4 с.

микросхемы после демонтаха использовать запрещается.

5.6. МИКРОСХЕМИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С НЕФОРМОВАННИМИ ВЫВОДАМИ:
ПОТРЕВИТЕЛЬ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ МИКРОСХЕМ В АППАРАТУРУ ПРОИЗВОДИТ
ФОРМОВКУ ВИВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С РИС. 9.

5.7. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕШНИХ ВИВОДОВ В РЕЖИМЕ "ВХОД-ВИХОД"

С ТРЕТЬЙИ СОСТОЯНИЕМ ВЕЛИЧИНА РЕЗИСТОРА МЕЖДУ НИМИ И ИСТОЧНИКОМ

ПИТАНИЯ  $\mathcal{V}_{CC}$  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ, ИЗ ДОПУСТИМОГО ВИХОДНОГО ТОКА И

AJIBK.431432.013 TY

SUCT

23

POPMAM A

пинамического режима Работы микросхемы.

5:8: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МИКРОСХЕМ НА ОСНОВЕ БМК 6КО:347:414 ТУІ.

5.9. ПРЕДЕЛЬНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ДИАПАЗО-НЕ ТЕМПЕРАТУР:

напряжение питания Усс не волее 7,0 в;

входное напряжение низкого уровня Их не менее минус о. 4 В; предельная емкость нагрузки Сл не более 150 пф:

Enodo. Modo. U dara B3aM. UHBNUH. 'dydo. Nodo. U

АДБК. 431432. 013 ТУ

## 6. Справочние данные

- 6.1.ЗАВИСИМОСТИ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМ ОТ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВЕДЕНЫ НА РИС.12-21.
- 6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНИЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРИВОДЯТСЯ , ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, В КАРТЕ ЗАКАЗА.
  - 7. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-

изготовителя

- 7.1. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ГОСТ 18725.
- 7.2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТО ЛЕТ СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
- 7.3. ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА 50000 Ч. В ПРЕДЕЛАХ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ.

DOUGH BOUSH GOORYM. ROOM. Lland

АДБК.431432.0I3 TУ

І АЧОНИЯ ЗИНАВОНЧИНА І  О КИНАВОД ЧЧОНО)  О КИНАВОД ЧЧОНОВО  О КИНАВОД ЧЧОНОВО  О КИНАВОД ЧНОВОВО  О КИНАВОД ЧНОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВОВ	ТИП ПРИБОРА RNHABOLY (ОБОРУДОВАНИЯ	I IPUMENAHUE ) I I
I RNHATUN ANHPOTON I	липс п <del>-2</del> 0	
І СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО І І ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО І І КОНТРОЛЯ ЦИФРОВЫХ БИС І	СТВНД - 1383	
І ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ І І ПРИБОР І	цуип	
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ I	F5-48	
І ОТОНАКАНОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО І В ВОПОТЕНТОВ І В В В В В В В В В В В В В В В В В В	ЛАДА И-II ЦИОН 590	I I* ПО СОГЛАСО- IBAНИЮ С ПОТРЕ- IEИТЕЛЕМ
BECH JAGOPATOPHNE I PABHONJEYNE I	BAP-200	

примечания: 1. Допускается применение приворов, отличных от указанных в перечне, но обеспечивающих проверку требуемых параметров и заданную точность.

\*. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА УСТАНОВКЕ ЛАДА И-II ШИОН 590 ПРОВОДИТСЯ НА ЧАСТОТЕ НЕ БОЛЕЕ 5 МГЦ ПРИ Vcc = 5 в+5%. ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ  $Vil \le 0,5$  в, входное напряжение высокого уровня  $Vih \ge 3$  в. Компарирование логической информации проводится при  $Vol \le 1,0$  в и  $Voh \ge 2,0$  в. Микросхемы, прошедшие функциональный контроль на ладе и-II маркировать белой точкой.

АДБК.431432.01**3** ТУ

JIUCT 2.C

PODMA 50 NO FOCT 2.106-68

9: перечень прилагаемых документов

I:ГАБАРИТНИЙ ЧЕРТЕХ ЩИО.073.242 ГЧ

2.СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ ЩИЗ. 480.311 ЭТ

3:ОПИСАНИЯ ОБРАЗЦОВ ВНЕШНЕГО ВИДА ЩИО:348:071 Д2 иио. 434.02922

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МБИС С ПРИМЕНЕНИЕМ САПР

6K0.347.4I4 TYI.

5. KAPTH ЗАКАЗА: УІЗ. 414.407 Д. УІЗ.414.408 Д.

- УІЗ: 414:409 Д

6:СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ: УІЗ:480:075 ЭЗ

У13.480.076 93

y13:480:077 93 \*

ДОКУМЕНТИ ВИСИЛАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЯМ:

стоящим на абонентском учете по специальному

запросу - договору:

АДБК.431432.013 ТУ

27

PODMA 50 NO FOCT 2.105-68

PODMOM A

# Соипочные нормативно-технические докушенты 10: перечень обозначений докупентов, на которий

### -дани соилки в ту

I ОБОЗНАЧЕНИЕ  « I ССИЛОЧНОГО ДОКУМЕНТА	I JUCT
I FOCT 18725-83	12,8,10,11,23,25
I FOOT 15150-69	12
FOCT 17021-88	12
I FOCT 19480-74	12
1 FOCT 18683.1-83	115,16
1 POCT 18683:2-83	118
I FOCT 25359-82	135
I FOCT 21493-76	135
1 FOCT 23088-80	122,34
1 OCT II 0224-85	12
1 00T II 073:013-83	111,14,15,18,19,20,21,
	132 - 35
1 OCT II 073.915-80	12
1 OCT II 073:944-83	116,17
1 OCT II 073:063-84	123
I FOCT 21931-76	143,44
I FOCT 20:39:405-84	12
1 PD 11 0723-89	12,56a

USM NUCT Nº GOKYM. NOON. Ilana PODMOL 50. NO FOCT 2.106-68

АДБК.431432.013 ТУ

28

DODMOMA!

•						ТАБЛИЦА	ما				10 V
наименование Идраметра, Единица изме- Рения	1 Byk – 1 Byk	HOPMA HE LAE MEHEELBOIEE	HOCTE,	PEX   1   1   1   1   1   1   1   1   1	изиере выличи одное 1 пряже-1 е низ-1 го 1	ТЕСТОВОЙ В ХОДНОЕ В ХОДНОЕ В В М В В В В В В В В В В В В В В В В	Виход-1 ной ток, <b>До</b> ,	БИКОСТЬ НАГРУЗ- КИ, С4	TENIE PALY- PA,	IVAKT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	приивча-
<u>1.1. виходнов</u> <u>1.2. напряжение</u> <u>1.3. низкого</u> <b>уро</b> вня, в	Vax	5. -	±5.5	4,75	9.0	4,0	1,6± ± 1,5%		25 <u>±10</u> -10   3 70	3,3:4.I	
2.1. BNXOДНОЕ 2.2. НАПРЯКЕНИЕ 2.3. ВИСОКОГО УРОВНЯ В	Гбан	0.4	<b>1. 1.</b> 0 <b>1.</b> 0 <b>1.</b> 0 <b>1.</b> 0 <b>1.</b> 0	4,75	9,0	<b>4.</b> 0	10,4±5%	T.	25±10   -10   3   1   1   1   1   1   1   1   1   1	3,3,4,1]	
3.1. BHXOДНО 3.2. НАПРЯХЕ 3.3. НИЗКОГО ВНЯ ПРИ КЦИОНАЛ	1 Dou.	0,8	3 (±(1%+ (+15 MB)	5,25	0	5,25		<u> </u>		3.3.4.21	
- Z C X	754 1	<b>.</b>	(1%+  +15 mB) 	5,25	0	4,75 5,25		<b>4</b> 60	25±10  -10   70   3	3.3.4.2	

	наиненование идраметра, единица изме- рения		HOPMA  HE I HE  MEHERIBOJEE  I		NOPPEH-I HOCTE, II	PEXMIN     PEXMIN	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	TABA.5 TOBOH 2 AHOE 2 BHE BHE	ВИХОЛ- НОЙ ТОК, <i>ZO</i> ,	EHKOGTBITENHETHYHKT HATPY3-1PATY-1 TY KM, 1PA, 1  CL 1 C 1	TEM IEE II PATY – I PATY – I PA Y – I – C – C		HAR HAR
	5.2. HOTPEBAEHUR, 5.3. HOTPEBAEHUR, 6.1. TOK YTEЧКИ 1 6.2. HUЗКОГО И 1 6.3. BUCOKOГО И	R. Zee Zieu Zieu		8 0 S 10	St St		УРОВНЯ. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 5,25			101 <u>25</u> 25 -101 -10 13 -10 13 -10 13 -10 13 -10 13	3.3.4.4	
AJBK.4314	ВХОДЕ, МКА 7.1 ВИХОДНОЙ 7.3 И ВИСОКОГО УРОВИЕЙ В СОСТОЯНИИ "ВИКЛЮЧЕНО" ижА	""   ""   ""   ""   ""   ""   ""   ""	1 I O		<b>1</b>	52		5.25	<b>1</b>		25±101 -10 13 70 1	3,3,4,5	
132.013 TY													
NUCT													

COLUMN TO THE PARTY OF THE PART

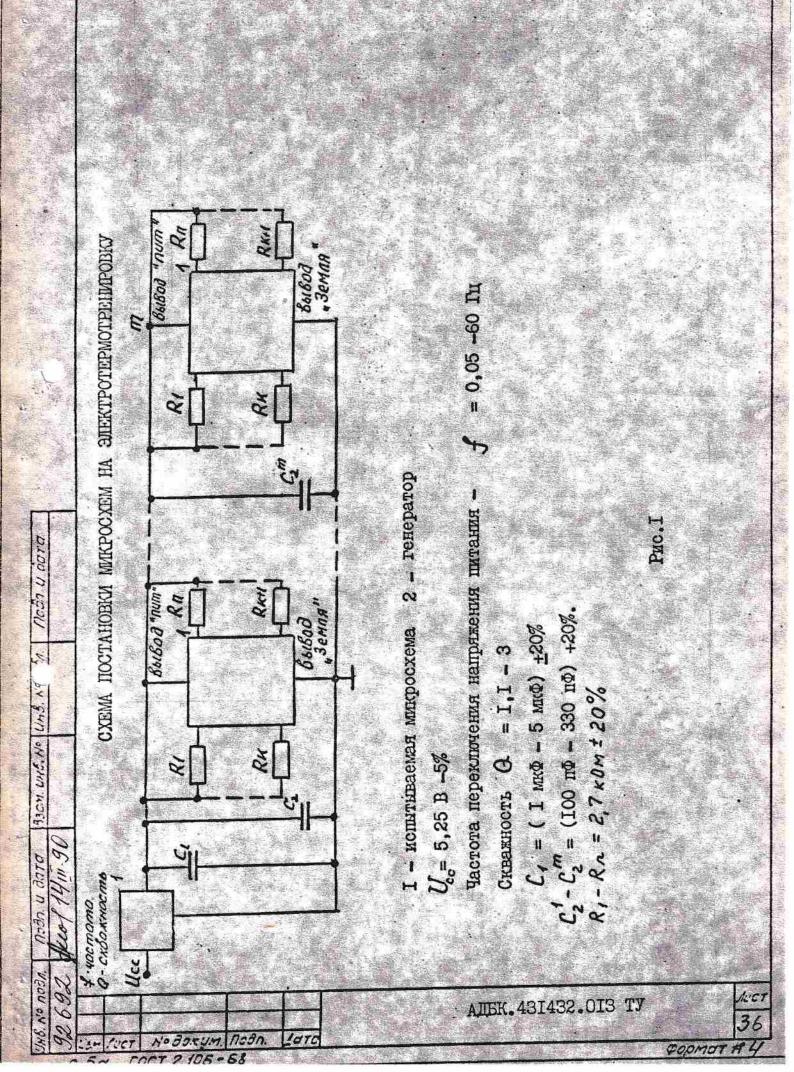
	IPOJOJXEHNE TABJ.5	$BYK-$ НОРМА ПОГРЕП-1 I 13НА ЧЕНИЕ ТЕСТОВОЙ ВИХОД-1ЕМКОСТЬ ГЕМПЕ ПУНКТ ПРИМЕЧА ВЕН- НОСТЬ, ІНАПРЯ-1 ВЕЗМЧИНИ 2 НОЙ ІНАГРУЗ-1РАТУ-1 ТУ ІНИЕ ПОСТЬ І ЖЕНИЕ ІВХОДНОЕ ІВХОДНОЕ ГОК, ІКИ, ІРА, І НА ІНИЕ НИЗ-1НАПРЯЖЕ-1 $Z_0$ ,	, †	Hù d	ANETROB, BPENE AHABINBATЬCЯ I	
W B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	1411.30		*   -   77   -	m VIC	3 HAPAMETPH KUHIP * - KOHKPETHNE 3H B KAPTE 3AKA3 B KAPTE 3AKA3 C YKA3AHNEM M	

		AHUR LUPUNE	TV HKT	13.3.3.2		1	1 3 3 1 1 1	19.3.4	1.9.8.61	9.3.6.2		13.3.4	1 + 3 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6	13.3.6.2 1	
	таблица 6.	NETON UCHUTAHUR	HUR I NETOL HO IN NOTALIA IN NOTA	405-1;3	1 / / / / /		1 to 2	1-005	203–I	201-1.1	200+I	500-7	<del>-1-602</del>	201-1.1	
		HAPAMETPOB 1			IOUEHKA I IMAPKW- I								· · · ·		
		HOMEPA HAPA TBETCTBNN C	IB IPOUEC ICE NCIN- ITAHNA	100 000CAHUD 105PA3U0B	18KAA 14KO.348. 1071 H2	INO VEPTEXY INNO.073.	V. 62 - 27	I.I;2.I;5.I 6.I;7.I	1.2,2,2,5,2	I.3;2.3;5.3 6.3;7.3	* H. 80	3.1,4.1	3.4.4.6	3,3,4,3	
		ВВ	INCTRATATION TENTOR										7		
92 692 Oly 14 jn 90		BMM M NOCIEDOBATEABHOCTE	MCIIB TAHMR	ПРОВЕРКА ВНЕШИЕГО ВИДА И МАРКИРОВКИ		IPOBEPKA FABAPUTHUX, YCTAHO- BOYHUX W IPWCOEJUHUTEJHUX PASMEPOB	. IPOBEPKA CTATUYECKUX IIAPAMET POB, OTHECEHHUX K KATEFOPUN "C" PDW.	HOPMAJBHUX KANMATUYECKUX YCAOBUSX HOHNIEHHON PABOYEN TEMHEPATYPE		DUBNUEHHON PABOYEN TEMIEPATYPE   CPEUN		12/2/2017		901Q-F	
692 Shuti		7.7.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	TAHUR I	K-I C-I C-I		K-2 C-2 1	K-3 II.								
1	MJ/UCT.	Nº∂	0KYM.	Nodn.	<u> </u>			AZ	БК.4	31432	.OI3 TV		<i>\$701</i>		NUCT 32

	I TPWNE-				PMC.2		PHC.2						PMC.2		
51.6	NCINTAHUR I IIVHKT			1.0.	13,3,6,2	13.3.4	13:3:6:2	13.3.6.3	13.3.5.3	13:3:5:1		13.3.8	13.3.7.I		
IPOJOJEHUE TABIL 6	метод испы метод по	001 II 073.013	4-606	•	201-2.1	500-7	20I-2;I	205-1	107-1	I-90I		208-2	1-00 <i>L</i>		
	APANETPOB C TABN.S HOCAE	Спитания	[1.2,2.2,5.2] [6.2,7.2] [8.2.*	1.3,2,3;			3.3:4:3	1.1,2.1;3.1  4.1;5.1;6.1  7.1;8.1 *	1.1,2.1	I.I;2.I	HH	7.1:8.1.*			
<u>a</u>	100 To 10	MOBUTAHNA 	11.2,2.2,5.211. 16.2** 7.2**16.	1.3,2.3; 5.3.6.3;	*	1. 4. I.	1.3;3;4;3	1			5.3**		11.3,2.3,3.3 14.3,5.3,6.3 17.3,8.3 *		
YON MOON U CLATO	ПОРЯДКО В В	ИСПИТАНИВИ   	1.2;2,2; 15.2;7.2	II.3;2.3; 15.3:6.3;	7.3*			1.1;2,1;3,1 4,1;5,1;6,1 7,1;8,1,*	1:1;2:1	I.:1:2:I	1.1;2,1;3,1	7:1:8:1*	1.1;2:1;3.1 4.1;5.1;6.1 7.1;8.1 *		
116 Nº 1100 1100 1100 1200 120 120 120 120 120	I ВИД И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ I		II.NCHUTAHNE HA BOSAEHCTBNE I I NCHWEEHON PABOURN	MET Inne	1 ТЕМПЕРАТУРИ СРЕДИ 13. ФУНКЦИОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ	I IPN:HOPMAJSHRX KJUHATU- I VECKUX YCJOBURX I NOBUMEHROÙ PABOYEÑ	PE CP	итиспитание на воздеиствие и изменения температури и среди	12. NCHNTAHNE HA BOSAERCTBNE I	на воздействив ударов	TEX G	i (MAINOPIEMEUNOE)	NCINTAHNE HA BESOTKASHOCTE		
269 1000 X	TPVII—I IIA IICIII—	ТАНИЯ	K-4 II-2					K−5 ∏-3					K-6 II-I		
S USM JUCI	Nº ∂OK 10. 50		nodn.	Dan 24	Service of Child	58	Α,	ДБК.43	143	2.0	[3 <b>Ty</b>			ПОРМО	SULT 33

			13.3.3.51	13.3.3.71	3.3.9.1 3.3.9.2 1	13,3,5,21	13.3.3.31	
квнив тавл. 6	INETOR NCHUTAHUR INETOR NO IOCT II 073.013	407-I 109-I, 110-3	402-I 403-I	208-2	404-2   FOGT 23088   408-1.4	104-1	406-1	
продолженив	ния	OUEHKA   MAPKUPOBKU     KOHTPOJS   BHEMHETO   BHAMA	MAKPOCKEME	11.1;2.1;3.11 14.1;5.1;6.11 17.1;8.1 *	 	11.1;2.1;3.1  4.1;5.1;6.1  7.1;8.1*	•	
	IE HOMEPA HAPAMETPOB HOTBETCTBUM C TABM.5 IB HPOHECGE I HOCHE			_				
	HOPFIKOBEE HOMEPA III B COOTBETCIBUM I HEPEI IB IIPOHI	1.1.2.1.3.1. 4.1.5.1.6.1. 7.1:8.1*	1.1;2.1;3;1; 4.1;5.1;6.1; 7.1;8:1 *	-		1.1;2.1;3.1;  4.1;5.1;6.1;  7.1;8.1*	I B3BEIINBAHNE	
14m30	BUZ N GOCAEZOBATEABHOCTS 1	CINCOBEPKA KAYECTBA W ПРОЧНО- CIN HAHECEHWR MAPKWPOBKW W CIOWKOCTW K MODEWW CPEMCTBAM IPOBEPKA ПРОЧНОСТИ ВНЕШНИХ BUBO ДОВ	. NCTUTATABE BUBOJOB K . NCTUTABUE UPW TAKKE	BJAXHOCTS	MCHHTAHNE YHAKOBKU  I. HPOBEPKA TABAPUTHUX PASME- 1 POB HOTPEBUTEJBCKOÑ N TPAH-1 CHOPTHOÑ TAPN 2.NCHUTAHNE HA HPOYHOCTE HPN 1 CBOBOJHOM HAJEHNN	ИСПИТАНИЕ НА УДАРНУЮ ПРОЧ ПОСТЬ (МНОГОКРАТНИЕ УДАРЫ)	K-IOII, IPOBEPKA MACCU	
692 040	TPSH-1 IA II NCIN-1	K-7 11.	<u>5 - <del>1</del> - 1</u>	<u> </u>	K-8 [I	K-9 1-5-1		1/10

		I TPUNE I YAHNE	_	T D M C			0 PNCIO	T I PMC.2			
	•	ния	I II Y HKT I TY	13.3.6.6	3.7	13:3:6.5	13.3.3.10	3.		ipouecce,	
	HIL	DOM:	1 METOA NO 10CT II 073.013	210-1	700-2:2	207-2	410-1	700-2.1	LOCT 21493	нспитаний до, в пр проводят не позднев	
		A E	ИОСЛЕТИСТИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	11.1;2:1;3:1 14.1;5:1;6:1 17.1 8.1* 11.1;2:1;3:1 14.1;5:1;6:1	;3,1 1,1,2,1,3,1 ;6,1 4,1;5,1;6,1 *  7,1;8,1*	3***   [I.1.2.I.3.I] 3***   4.I.5.I.; 6.I  7.I.8.I*	 	;3.3 I.1;2.1;3.1 ;6.3 4.1;5.1;6.1 *  7.1;8.1*	;3.I!I.I;2.I;3.I ;6.I!4.I;5.I;6.I * 17.I;8.I *	РУППЕ ТИПОБ АК". ИСПИТАНИЙ	
		AKUBNE B COOTB	ПЕРЕД ІВ ПРОЦЕССВ ИСПИТАНИЕМ ІПСПИТАНИЯ	2.1,3.11 8.1* 2.1,3.11 5.1;6.11 8.1*	2.1;3.111.1;2.1 5.1;6.114.1;5.1 8.1* [7.1;8.1	.2.1;3.1! .5.1;6.1! 5.3* .8.1*		2.1;3.111.3;2;3 5.1;6.114.3;5;3 8.1* 17.3;8;3	;2.1;3.1 1,1;2.1 ;5.1;6.1!4,1;5.1 ;8.1 * (7.1;8.1	ETPOB HOPMIN TOLISKO A H B KAPT TPOB HO	
		ATEMPHOCTE !	I NCII	BOSAENCTBNE 11.1 HOBRUEHHOTO 14.1 BOSAENCTBNE 11.1 HOHNXEHHOTO 14.1	II.I I4.I AOJEOBETHOCIS 17.I	BOSAEHCTBRE HOII. I KHOCTH BOSAYXA 14. I SS HOKPUTHA 17. I	HA CHOCOBHOCTE 1 OPEHNE 1 HA FOPDUECTE 1	II.I IFOBEWHOCTE 17.I	COXPAHRENOCIS II.I	CPE DE CREE CORNER CORN	
11411190		вид и последо	ACHRIA	2. ICILITAHNE HA BO ATNOCQEPHOFO IO ДАВЛЕНИЯ 3. ИСПИТАНИЕ НА BO ATNOCQEPHOFO IO ДАВЛЕНИЯ	испитанив на до	I. NCHUTAHNE HA BOSAEHCTBH BRUEHHON BAAKHOCTN BOSA (ANNTEIBHOE) BES HOKPUTNA MNKPOCXEN JAKOH	HA FOPE HA	Т.ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	проверка на сох	: I.M3MEPEHNE 106JE NCH 2.CTOKKOCTE *-ANHANNYEC **-TOJEKO HA ***-IIPOBEPKY IS MNHYT	
692 100	17000	IA I			 		K-1511	و	×	примечания	
SO NEW I	UCT. Nº	dok.	YM.	Nodn. Van	) 5-68	АДЫ	<b>(.</b> 43I4	132,013	Ty	SENSON SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	35



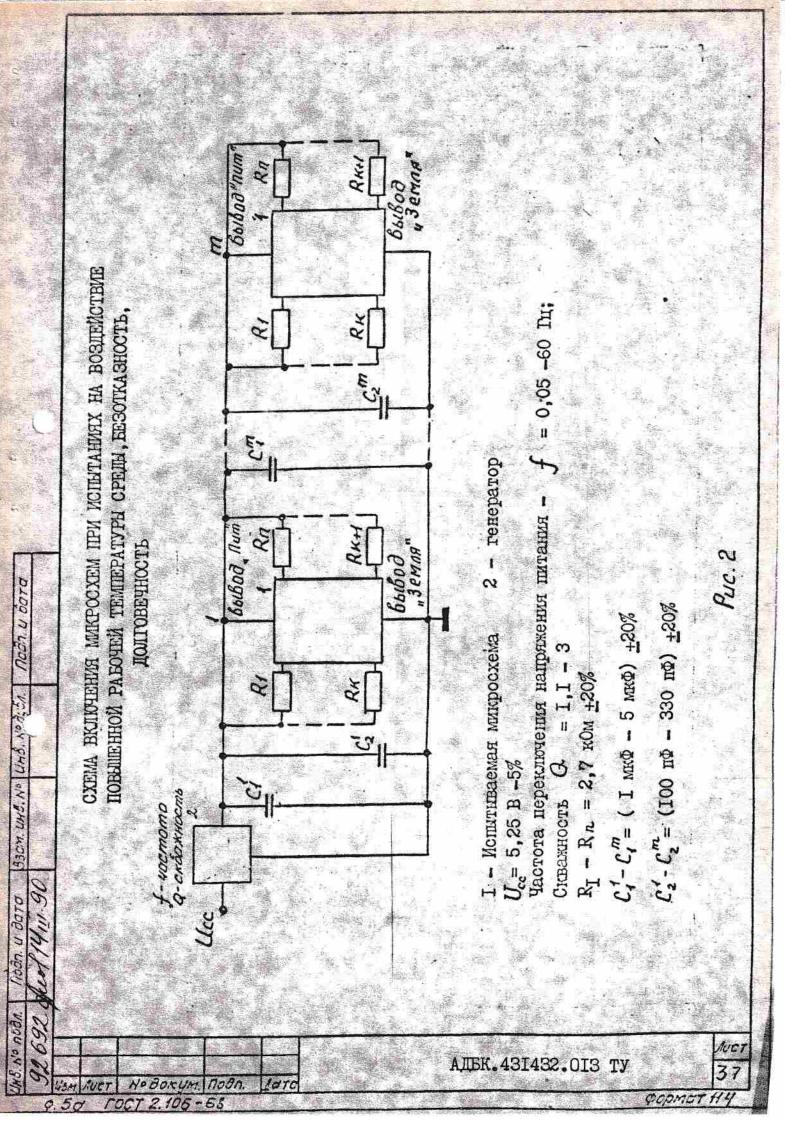
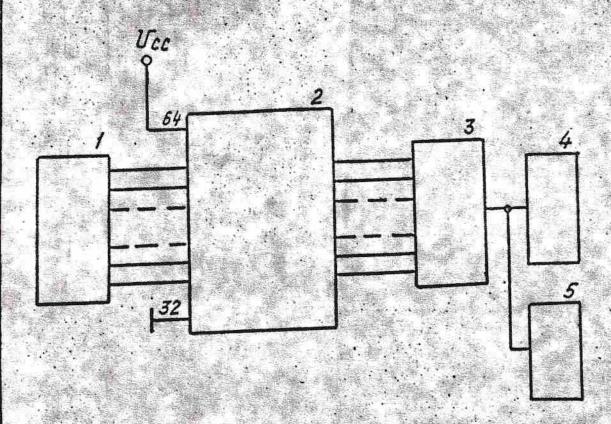


Схема измерения виходного напряжения високого уровня,  $U_{OL}$  и виходного напряжения низкого уровня,  $U_{OL}$ 



- I формирователь входных кодов
- 2 проверяемая микросхема
- 3 коммутатор выходов
- 4 генератор тока
- 5 измеритель напряжения

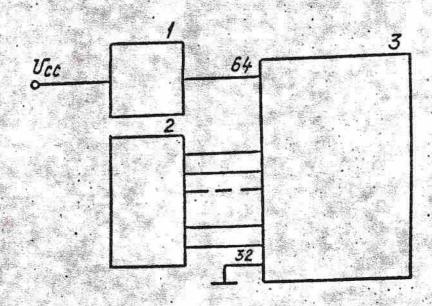
PMC.3

AJIBK. 431432.013 TV

10ct 38-

CODMOM A

Схема измерения тока потресления,  $I \varepsilon \varepsilon$ 



- I измеритель тока
- 2 формирователь входных кодов
- 3 проверяемая микросхема

Puc.4

WISH JUCINIA CORUM. MOCIO. LIGITA.

WOOMO. 50. POCT 2.106-68

АДБК. 431432.013 ТУ

39

ODDOMOM AS

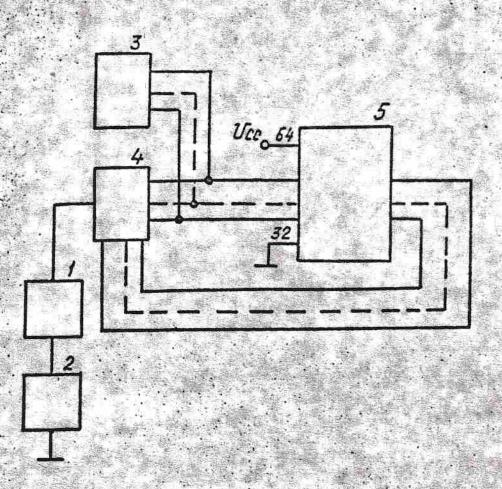
Схема измерения токов утечки

низкого и високого уровней на входе (втекающие)  $I_{LIH}$ .

(витеканцие)  $I_{LIL}$  и виходного тока в состоянии

"Виключено" при напряжениях низкого и високого

уровней  $I_{III}$   $I_{III}$ 



- I измеритель тока
- 2 источник питания
- 3 формирователь входного напряжения
- 4 коммутатор контролируемых выводов
- 5 проверяемая микросхема

PMc.5

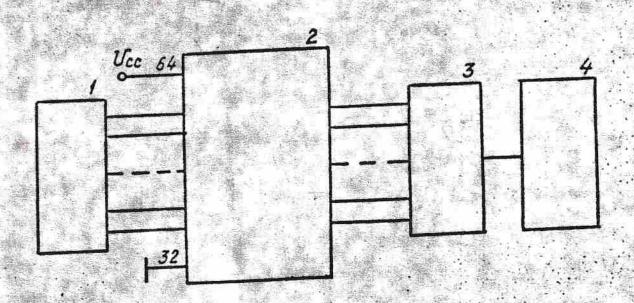
USM JUCT Nº OOKYM. NOON. Law

**ДДБК. 431432.013** ТУ

40

CODMOUNT AY

Схема измерения виходного напряжения високого уровня,  $U_{OL}$  при и виходного напряжения низкого уровня,  $U_{OL}$  при функциональном контроле



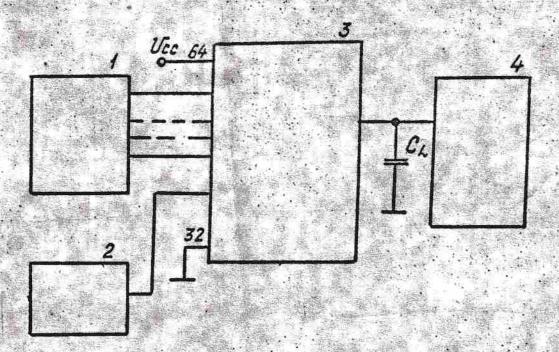
- I коммутатор входных воздействий
- 2 проверяемая микросхема
- 3 коммутатор выходов
- 4 измеритель напряжения

PMC.6

. *(100an, Ilano* 

41

COODMOM A



- I формирователь входного напряжения
- 2 генератор входных импульсов
- 3 проверяемая микросхема
- 4 измеритель временных интервалов

 $C = 50 \text{ nD} \pm 20\%$  — эквивалент нагрузки, с учетом паразитных емкостей.

PMC.7

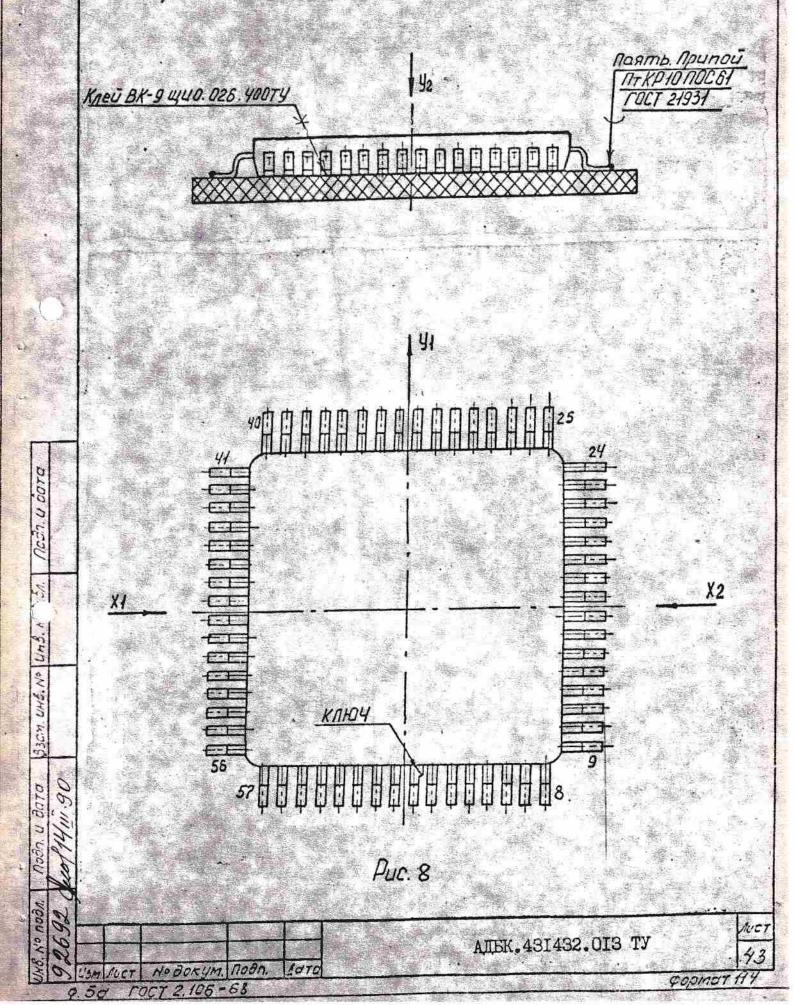
SHJUCT HOOKYM. NOON. Ilara

АДБК.431432.013 ТУ

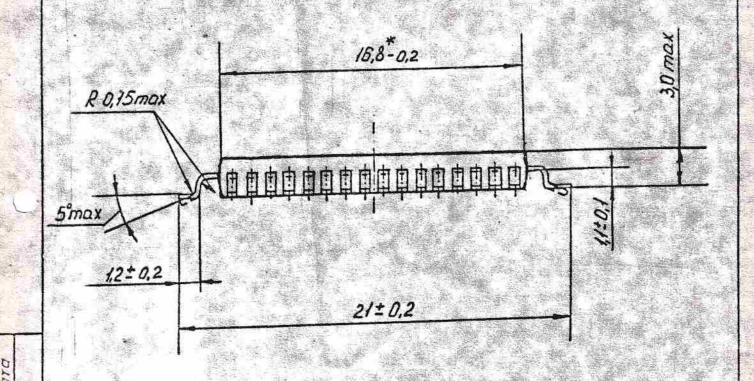
42

CODMOM A4

Пример установки микросхемы на плату и направления воздействия механических нагрузок



Рекомендуемые размеры формовки выводов.



- 1. \* Размер для справок.
- 2. Выводы на длине не менее 1,2 мм лудить припоем ПТКР10ПОС 61 ГОСТ 21931

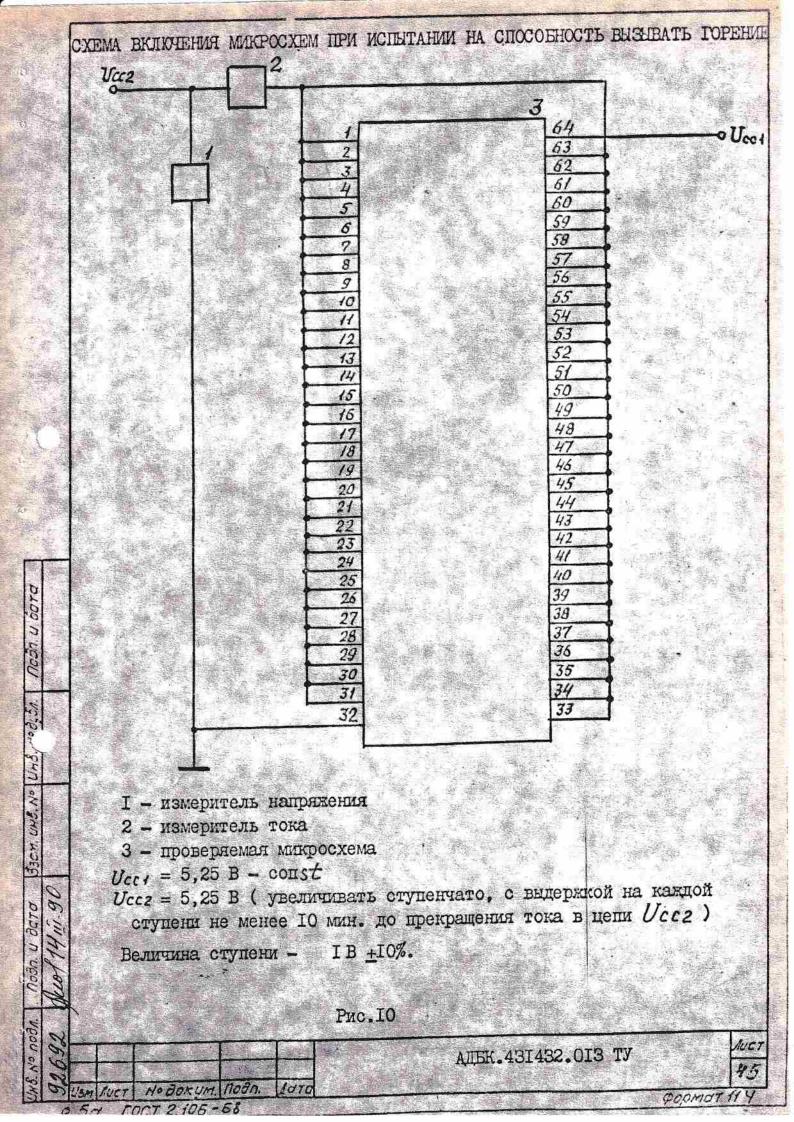
Puc.9.

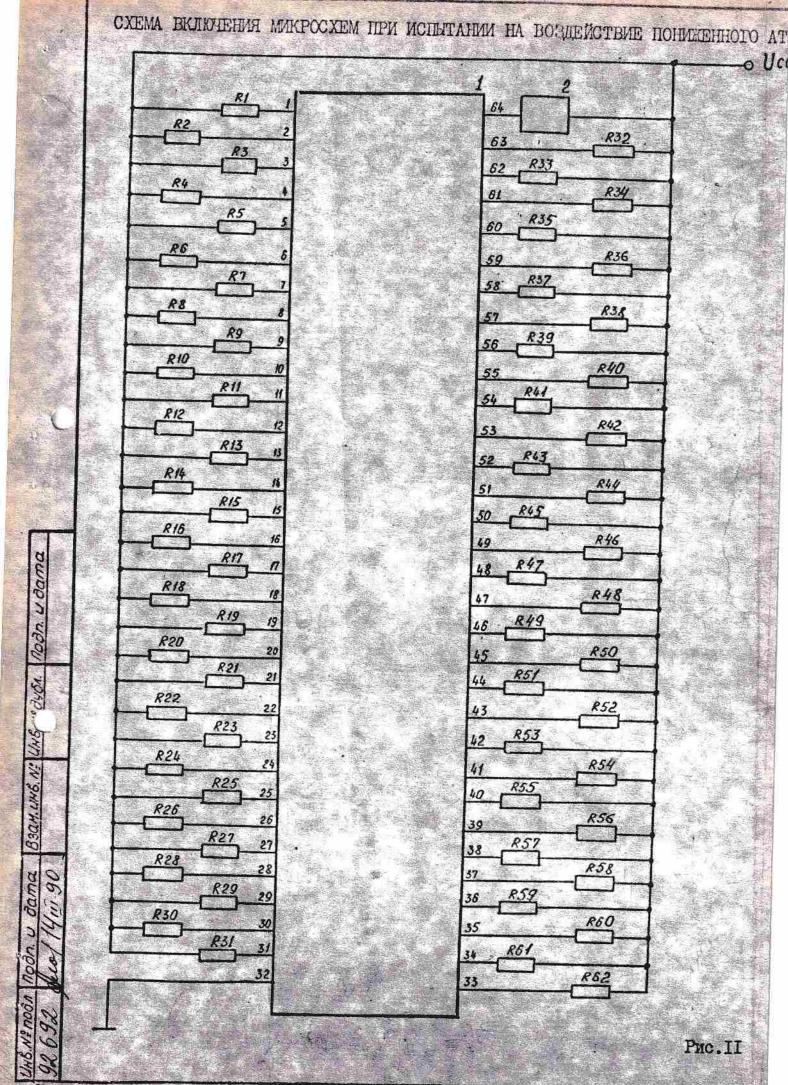
SEN TECT HOBOXUM NOON LOTO

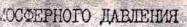
**АЛБК. 431432.013 ТУ** 

44

GOOMOT AY







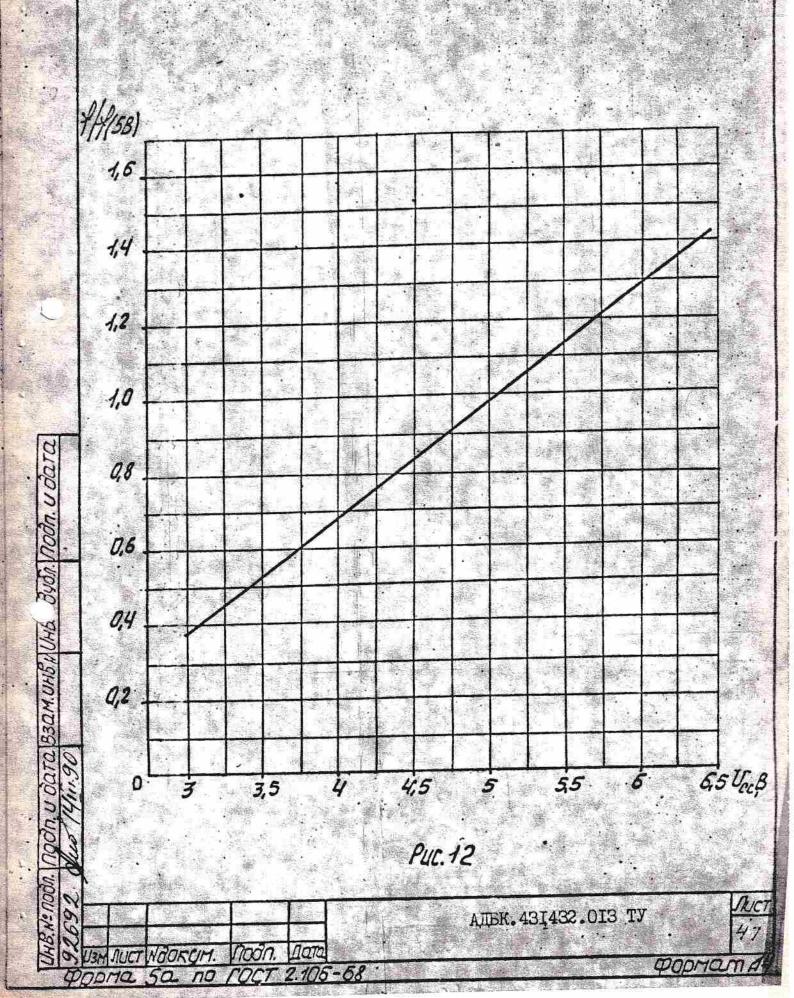
RI... R62 = 2,7 kOm  $\pm$ 20%  $U_{cc}$  = 5,25 B  $\pm$  5%

I - испытываемая микросхема

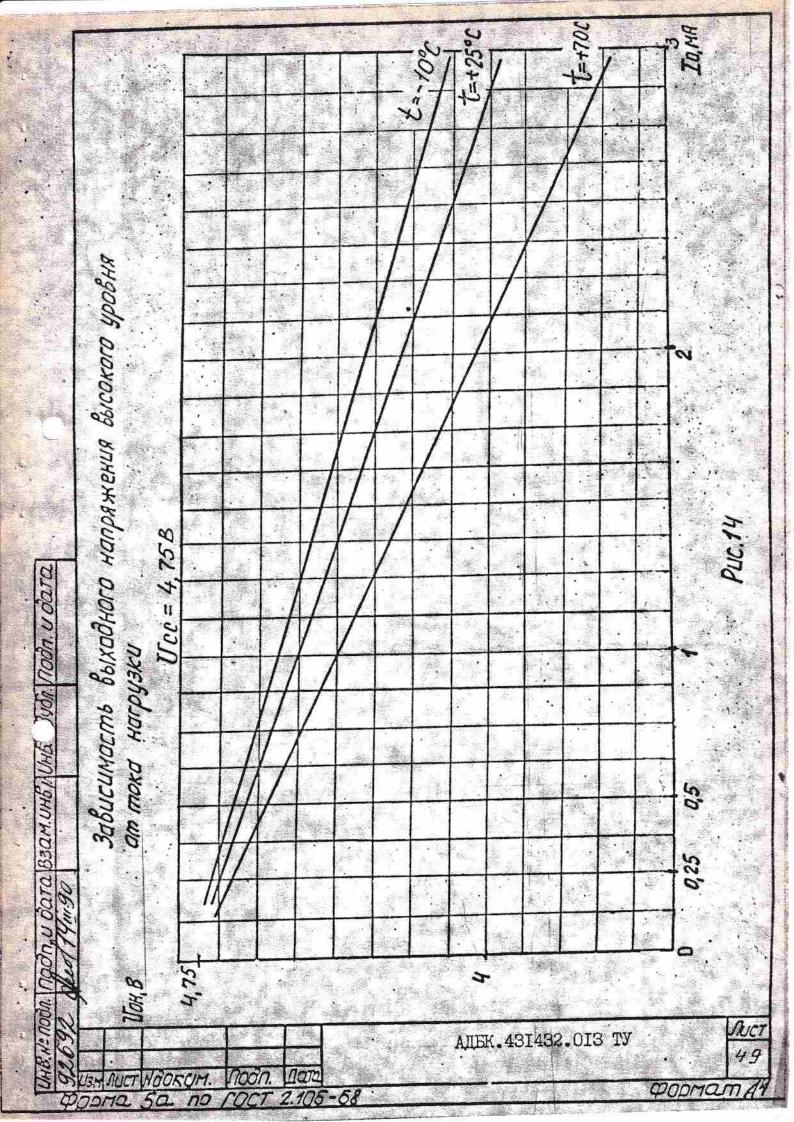
2 - измеритель тока

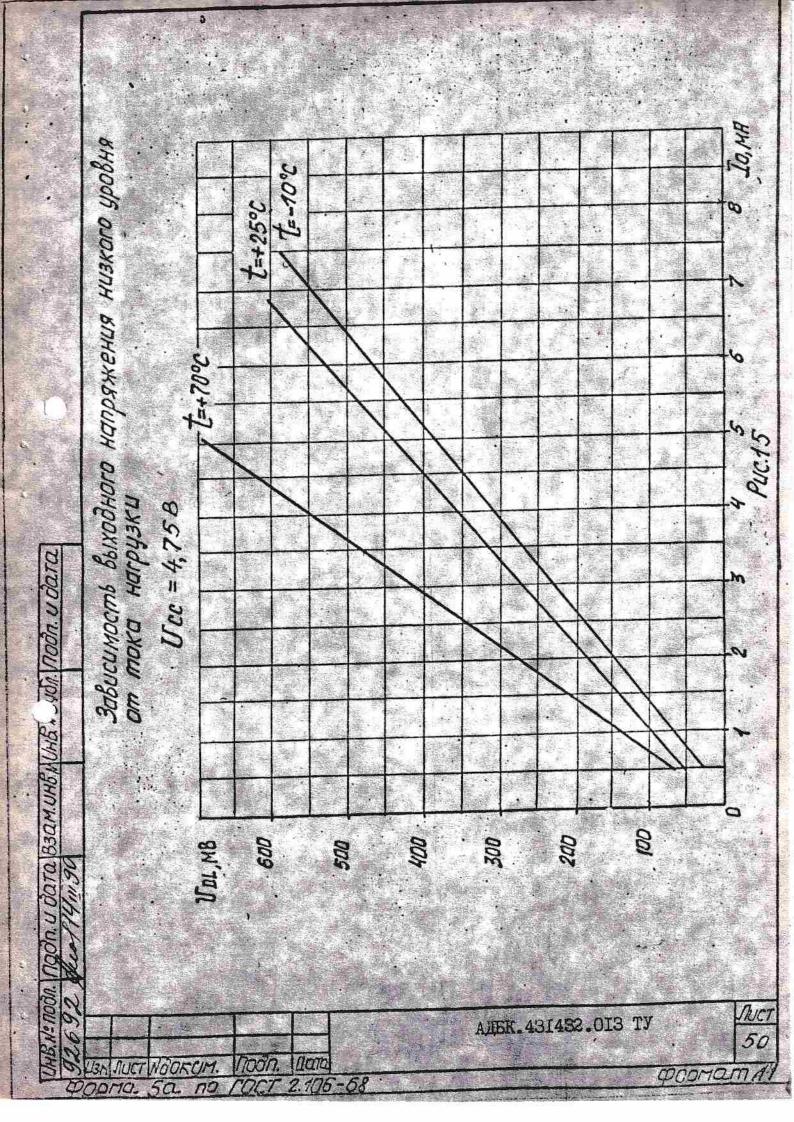
UIM	luch	Hº BORUM.	Подп.	Para	
				1,00	110455
Sec					

### Зависимасть нармализаванной вхадной настоты ат напряжения питания

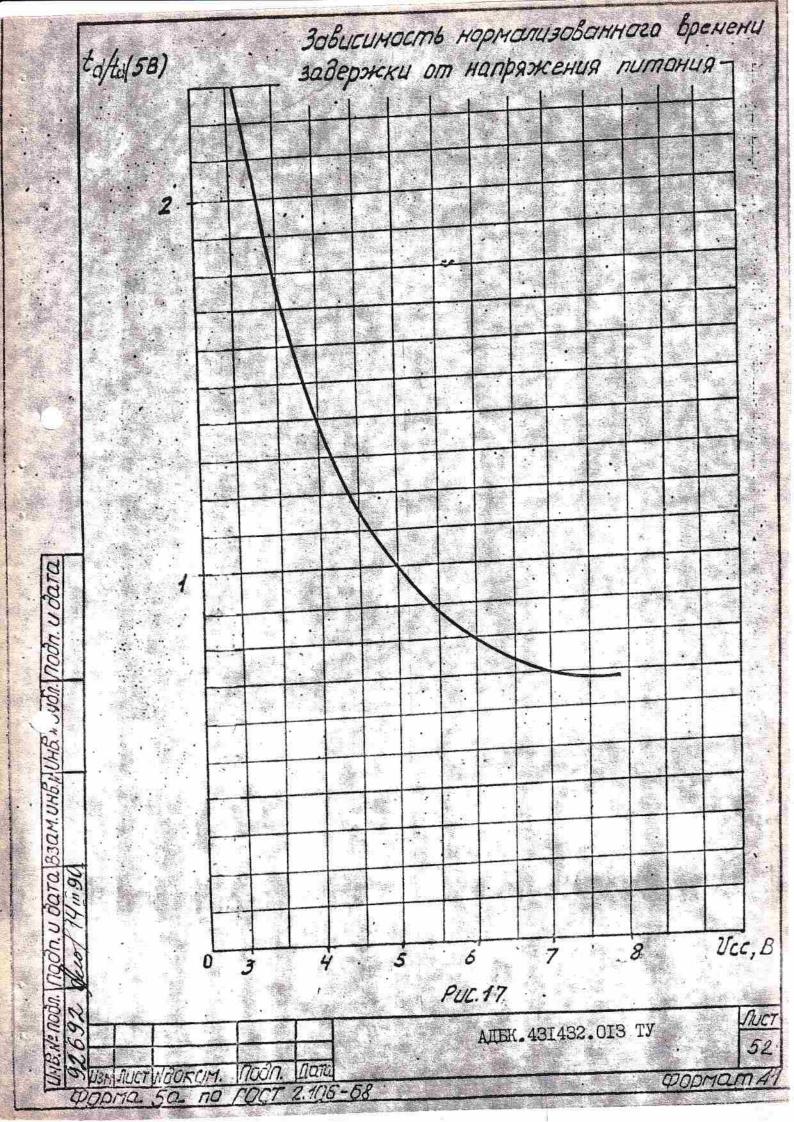


tofto(15np) 1,3 1,2 1,1 140 CL, 114 120 100 PUC.13 АЛБК. 431432.013 ТУ SUSH JUCT HOOK CIM. Moon. Lagra COPMOM A

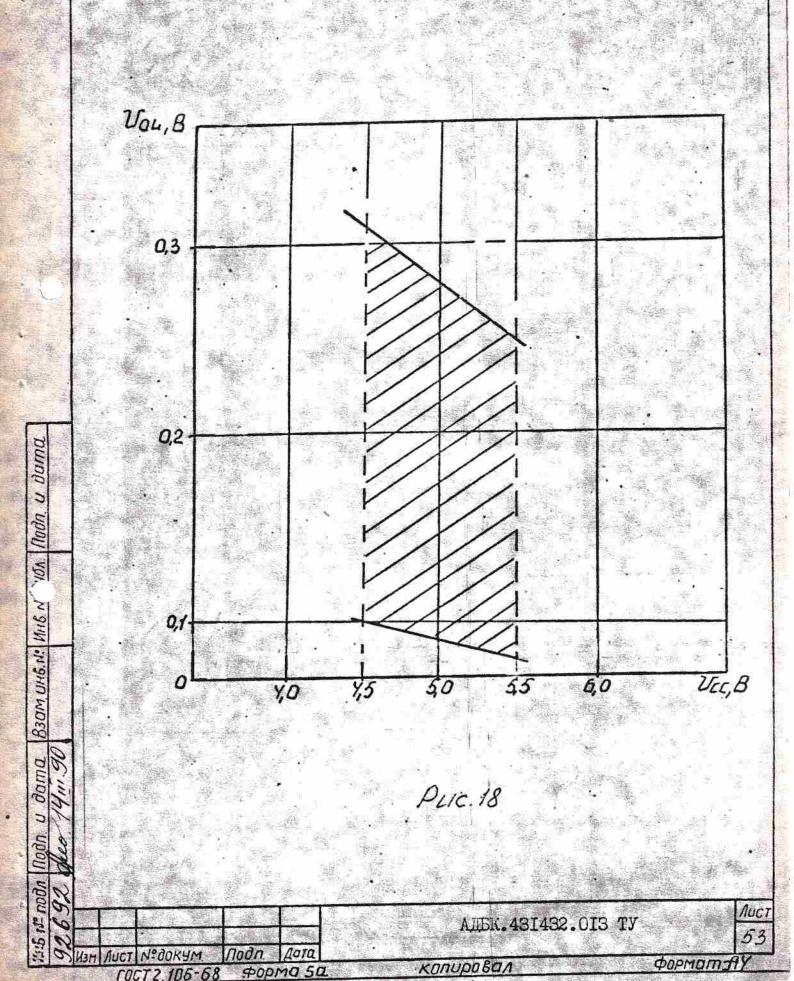




地の一切地で	200	CPITTOROGRAM		1000				The state of	1.5				A MILES	の記述の		Medican	STATES OF		100 V	Sec. 18	
2.7		120	2		90	9							20	Ø	7 1	•					
											-								36.0		
									**************************************		31 n 4	- 4	21.14h		数 = .					5 A	
				rts.												02				祖 鴻	
	**************************************						i.	le.	90			(計畫)			-19						
			- E					1		V-1	250g					12.0					
										Spix 155			31mg			92	No.		a A		
															Sin. V		3				
				4		Table 1		i ba			***					45					灣.
				SELECTION OF THE SERVICE OF THE SERV			•						*					FI DE			
		7.48	Exit	-16 X			118	36.				2.5			1						
				**			3 A				\	1	1 6 1 A			\$			•	p de	Hells Little
				5. A	pio				$\setminus$	$\rightarrow$				reside Since							
<b>1</b>							1	1				N N			ALC: UNIVERSITY	15					<b>T.</b>
				#1 .95 #1			$\mathbf{H}$				1 P						3		120	4	
	STATE OF THE PARTY OF		ジャ		нармализаванного времени задержки	nH.	<i>9</i> ₩8	1994 H	oro	\$	308	8	OMO	3abucumacms Hap am memnepamypu ta/ta/t=+25%	200 mg	1001		dbu 7. n 14=	.vs 8		

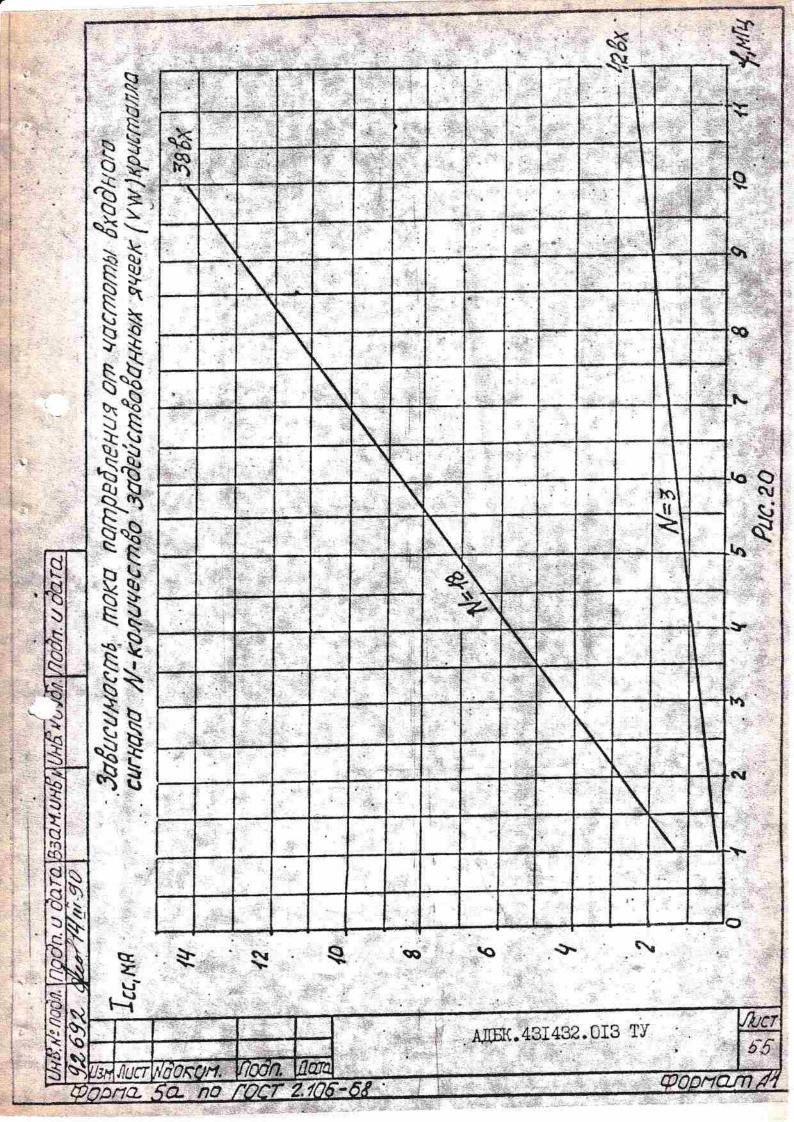


### Зависимость выходного напряжения низкого чровня от напряжения питания



FOCT 2.105-68

## Зависимость выходного напряжения высокого уровня от напряжения питания UQH; B 5,5 5,0 4,5 4,0 Vcc, B 0 5,0 5,5 5,0 4,5 4,0 PUC.19 **АЛБК.431432.013** ТУ COPMOM A



# Зависимость нормализованного тока потревления от напряжения питания t=+25°C Techter \$8 0,8 У. Подп. и дата 0,6 B30M CHEN! WHE NOT Vcc, B Puc.21 Auci **АДБК. 431432:013** ТУ JUCT Nº BOKYM Падп. Konupagan VPcmama04

HACTORWED RPHJOREHUE K ARBK: 491432: 019 TY COREPXUT YTOTHE-HMR TY RPH HOCTABKE MUKPOCKEM B SECKOPHYCHOM UCHORHEHUN HA OBMEN... HACTUHE (RAREE MUKPOCKEMU) B COOTBETCTBUN C PR 11 0723:

- I: THE ENK RPUBERER B TABLE!
- 2. ТИПН (ТИПОНОМИНАЛН), ПОСТАВЛЯЕМИХ ИИКРОСХЕМ УКАЗАНЫ В ТАБЛ. 1a.
- Э: УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОСХЕМ ПРИ ВАКАЗЕ И В КОНСТРУК-ТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

MUKPOCXENA KEISISXM2-4-XXX

АДБК: 431A32:013 ТУ КАРТА ЗАКАЗА XX3:414:XXX д РД 11 0723:

- A; OSHUN BUR, FABAPUTHUE U HPUCOERUHUTERUHE PASMEPH MUKPO-CXEN, A TAKKE YHACTKU KOHTAKTHUX RROMAROK, K KÖTOPHU ROMYCKAETCH IPONSBORUTU BANKY U CBAPKY, YKASAHU HA UEPTEKAX, REPERUCREHHUX B TABRIS
- 5: ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ ВНЕШНЕГО ВИДА МИКРОСХЕМ ЦИО:734:029 Д2
  ПРИЛАГАЕТСЯ К ТУ:
- 6. SJEKTPUTECKÚE HAPAMETPU MUKPOCKEM HPU HPUEMKE U HOCTABKE COOTBETCTBYDT HOPMAN, HPUBEJEHHÁN B TAGI.2.
- 7. РЕХИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСХЕМ В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИВЕДЕНЫ В ТАВЛ:5 ТУ:

HOL OUR OWN FOOD HE OF

AJIBK, 431432, 013. TY

560

		OBOSHA VEHNE ISBEKTPHVEC- KOR CKENU		NW3.480.511 91				
Nodin u dama	I VIIIVI I	I KJACCNONKALNORHNE HAPAMETPH B HOPMAJB- HHX KINNATHYECKHX УСЛОВИЯХ (БУКВЕННОЕ ОБОЗ- HAЧЕНИЕ, ЕДИНИЦА ЙЗМЕРЕНИЯЗ	BUCORDE IBUXOIROE IMAKCOMAID- ICPEDRE IMOUROGIDI HAIPRXERME HAIPRIE- IHAR WAGTOTAIBPENS 3A- INCIPEE- I BUCOKOFO HER ENG- ENCHAIOS IMERINIS IHA BEH- I VPOBHR, IKOFO CUFHAIOS IMERTUID IHA BEH- I VOM, B IYPOBHR, CAFTHON PE-ICR B UEIOUIPCO, MBT. I IKMED, MFT IKE BEHTU- I INCHEE IKE BOIRE I	4,0 I 5 I I.3	TPOJOILEHNE TABL: I	IKOANYECTBOIKOANYECTBOIFPYINA IKOA 19aenehtob 18eminen 1tanob 1oka 18 cxeme 18 basobon 1 19aeneh 1 matphyhon 1 1 yeckor 1 kphctaare 1	23550   3200   I   63 31 24 9807	
BEOM LINE WHEN DYON ROOM U		L SYBKUN OHA ISHOE L ASBA VEHNE		INHOPOOVHKUNOHAMBHAR I UNOPOBAR I NATPUNA		1 OSDSHAVEHNE IKOJNYE 1 TASAPUTHOFO ISJENEH 1 WEPTERA KPHCTAJIASISHIP 1 WEPTERA KPHCTAJIASISHIP 1 WEFTERA	1 HM7,344,309	
926920 Rodn Lodn u dama.		VCTOBHOE OBOSHA VEHNE MNKPOCKENN		RBISTSNIZ-4		NCHOBROE DECENA YEAR WARPOCKENS	KBISISIN2-4	
Mile NE	Use Auct	<i>PASE 0488</i> N≗80K9M T 2 1015-	90 8e4- 27.550 Nota Agree 88 \$00MO 50.		AJJEK Konupol	.431432.013 aa	ı Ty	Фор

mulicare or	Mile M. 1000 1000 0 00000	BSOM UMEN! MME NEGYDA MEDIN	A Meda u damu				
T THE WAR			148	tabunk ie			
555 (1682 10 2 "dokyr: 110 2 (106-68	Vetobhoe Oboshavejime I mirkpoczenki	CKENU CKENU F GAEKTPHYECKOG *	OBOSHAYBHNE KAPTU Sakasa	OBOSHAVERME TABAPKTHOFO USPIFER (VEPIFER KPRCERARAS N	INCUSTATEMBHAS ITPYINA ITMROB	ТКОЛ ОКП	
ut a da A eopric	KEISISAKS-4-001 KEISISAKS-4-002	1713.480.075 93	VI3.414.408 I	1007,344,310		163 31 24 581	9817
\$30 500 15a	1015151R2-4-003	1713 180 077 33	604			W-1	(3)
		- ubprežu notpesi	HOTPESATEASH BUCHAADTCS	OR IN CHEMINALISMON'S	ONY SAMPOCY		
2.013 TV							
linews (m							
1061 368							

единица измерения, резим измерения	BYKBEH- HOE OBOSHA- I YEHNE	THE S	HE	医,可能增生的
BUXOДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НИЗКОГО УРОВНЯ, В ПРИ Ucc = 5B ± 5% I Zol = 1,6 мA	VOL		0,5	
BHXOДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ BUCOKOГО УРОВНЯ, В ПРИ ZCZ = 5B ± 5% ZOH = 0,4 мА		4.0		
TOK HOTPEBLEHUS, MA  HPM VCC = 5B± 5%	Zec	- Tage 1/2	0,8	
TOK УТЕЧКИ НА ВХОДЕ НИЗКОГО И ВИСОКОГО УРОВНЕЙ, МКА ПРИ VCc = 5B ± 5%	ILIL ILIH		5,0	
Виходной ток в состоянии "Виключено" при напряжении высокого и низкого уровней при ССС = 58 ±5%	Zozh Zozh		5,0	I
BPENS BALEPIKN, HC  RPN VEC = 5B ± 5%	Ź.D		• <b>-</b>	2

ПРИМЕЧАНИЯ: I: ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИХ

40K ADALD VIJE 45 Jane 2254

**АДБК.431432.013 ТУ** 

362

В КАРТЕ ЗАКАЗА: 2: КОНКРЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРХКИ ПРИВОДЯТСЯ В КАРТЕ ЗАКАЗА:

#### COHEPRAHNE

	A15		
	I	овцие положения	2
	2.	TEXHUYECKUE TPEBOBAHUS	5
A SA		2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ	5
		2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ	
		M PERUMAM	6
Ů,		2.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТОИЧИВОСТИ ПРИ	
		механических воздействиях	8
	:Th	2.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ	
		климатических воздействиях	8
		2.5. TPEBOBAHNA K HAZEXHOCTN	8
		контроль качества и правила приемки	10
	43.0	з. г. требования к обеспечению и контролю	
	No.	качества микросхем в процессе	
	24	производства	10
		3.2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	10
		з.з. методы контроля	11
	4:	маркировка, упаковка транспортирование и хранение;	22
	4.7	С. МАРКИРОВКА	. 22
	4:2	2. YHAKOBKA	. 22
	4:3	3. TPAHCHOPTUPOBAHUE W XPAHEHUE	. 23
	5:	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСИЛУАТАЦИИ	. 28
	6.	CHPABOUHNE MAHHNE	25
THE PERSON	7.	гарантии предприятия-изготовителя:	25
	8:	контрольно-измерительные приборы и оборудование:	26
	9:	REPETERS REMARKATION AOKYMENTOB	27
	IO.	DEPENDEND OF SHANEHUR HOKYNEHTOB, HA KOTOPHE	
		дани ссилки в тур	28
		таблицы	29-35
		рисунки	: 36-56
		Приложение	60, 8, 8, 2
	-		

АДБК.431432.0I3 **ТУ** 

57

QUOMO 50 DO FOCT 2106-68

GODMam A

лист

	Изм	Изменен НЫХ	листо Заменен ных	в (стра навых	ниц) аннули- рованных	Всего листов (страниц)	№ докум,	Входящий № сопрово дительно го докумен та и дата	Подп	Дати
		18;57,28;	2,20	564,568 568,562			HOBE OYSS. BBR 1021-80		I 410	2.90 2.91
	23	41,32 3							-0-11	Title
							19,15R 0869-91			
arna										
0								#		
yan Nodn u										
MHB h. Jye										7 19
B30M UHB Nº										
doma 4' in 30	Equ.									
2/	- RV									
2 Sheer										
H6 Nº DOGN				182			ДДБК <b>.</b> 43143	2.013 TY		Auc

Место для товарного Микросхема КАІБІБХМ2 знака предприятия (указывается изготовителя 450.37 регистрационный номер карты заказа) Rep6 OT NKETKA Микросхема интегральная КАТ5Т5ХМ2 Универсальная вентильная матрица (УВМ) Климатическое исполнение УХЛ Схема расположения выводов Intoriorucave) K11404 BROW UHB Nº P- 6052 Обозначение выводов показаны условно MM3.480.3II 9T Ham AUCT Nº BOKYM. Nagn Разраб Auom Aum Aucmo6 Микросхема MPOG. 2912 интегральная KA1515XM2 H. KOHTP Этикетка копировал: POPMam #4

Наименование пара-	Буквенное	HC	PMA.	
метра, единица измере- ния, режим измерения	обозначе— ние	Mence	не более	Примечание
Выходное напряжение низкого уровня, В при <i>Vcc</i> = 5B±5% <i>Tos</i> = 1,6 мА	Vox		0,5	
Выходное дапряжение внеокого уровня, В при $Zee = 5B+5\%$ $ZoH = 0.4$ мА	Von	4,0	<b>-</b>	
Ток потребления, мА — при <i>Vec</i> = 5B±5%	-Zoc		0,8	
Ток утечки на входе низкого и высокого уровня, мкА при <i>Vec</i> = 5B+5%	ILIL ILIH		5	
Выходной ток в состоянии "Выключено" при напряжении высо-кого и низкого уровня, мкА при Тес = 5В±5%	Iozh Iozh		5	
Время задержки, но при <i>Vec</i> = 5B+5%	<i>Ł</i> d		*	

Примечание ж — Конкретные значения времени задержки приводятся в карте заказа.

В карте заказа могут быть установлены другие

В карте заказа могут бить установлени другие динамические параметры с указанием метода контроля.

	ЩИЗ.480.3ІІ	e de la company
USMAUCTHEODKYM, MOON Jane		
DODMA 50 NO FOCT 2.10	5-68	Goomam 49

	Содержание драгоценных метал.	пов в 1000 шт.микроскем:
	золото	
	серебро	1.
	Цветных металлов не а	содержится
	Сведения о при	емке
	Микросхема интегральная КАІБІ условиям АДБК.431432.013 ТУ.	5ХМ2 соответствует техническим
	Место для	Место для штампа
	- mramma OTK	Государственной приемки
वेडकी, ज्वेत्र ए वंदत्त्व	Mecto wia utamia OTK	Место для штампа Государственной приемки
12,684 Shert Thin Su	2、 2012年11日,11日中央19年4日,11日中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本中央19日本	.480.3IT 9T
日の	LIM JUCT Nº BOKYM. NOON. MOTO	
	ΨΟΡΜΩ 50 ΠΟ ΓΟCT 2.106-68	Qopmam A4

	ИзН.	Изменен	Заменен	в (стро новых	ниц) аннули- рованных	всего листов (страниц) в докум	№ докум	Входящий № сопрово- дите льно- го докумен- та и дата	Подп	Дат
U dorma									in/i	
note ou										
DOUGLOUP INC									#4	
18										
1141119										
1 21:00				• 10 L					H.	
789						из.480.	JII ƏT			Лист

УТВЕРЕДАЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

4399 قلي

В.Г.ФЕДОТОВ

" 4945 I984T.

**YTBEPKIAO** 

DIABHM WEIGHED TREATMENTUS

п/я Р-6429

Torul A.A. HOHOB

"27 " 0> 1984r.

MUKPOCXFMH BECKOPHYCHHE MOJUMONKALINI 4 Описание внешнего вида шио.734.029 Д2

> гланный конструктор окр CET T.A. HIMPOKOB I984r.

1.1. Настоящее описание внешнего вида распространяется на микросхеми интегральные бескорпусные модификации 4 и предназначено для руководства при проверке качества внешнего вида пластии на предприятии-изготовителе и на входном контроле у потребителя.

• Описание высылается потребителю одновременно с техническими условиями на микросхемы.

#### 2. TPEEOBAHNA K BHEJIHEMY BULY ILLACTUH

- 2.1. Проверку внешнего вида пластин проводят визуальным осмотром под микроскопом с кратностью увеличения 50<sup>X</sup> при примом освещении объекта.
- 2.2. При проверке внешнего вида допускается следующее: различные оттенки алкминиевых контактных площадок, кроме черного и коричневого:

сквозние царапини, отсекающие менее I/4 контактной площадки; царапины и пустоти на металлизированных дорожках, уменьшающие ее ширину менее чем на I/2;

ециничные несквозние парапины по защитному окислу;

пестравленные участки металлических покрытий, уменьшающие расстояния менее чем на I/3 между двумя контактными площадками, между двумя любыми металлизированными дорожками, между контактной площадкой и металлизированной дорожкой;

остатки окисла и алиминия на дорожках реза;

JUNIUCI Nº BOHUM ROOM AQUA	Щио.734.029 д2	
PRODUCTION DE PROPOSITION DE LA COLLAGE DE L	Минросхемы бескорпусные модификации 4 Описание внешнего вида	A 2 4
Форма 5 ГОСТ 2.106-68	Konupaba ji	Qopmam II

различные оттенки зашитного окисла;

несквозные произлы и царалины от игл зондовой установки до поверхности кристалла размеров, не превышажими ширину выходящей металлизированной дорожки:

перапины и сквозные следы от игл зондовой установии, уменькатиче ширину металлизированной дорожки в месте перехода в контактную пломанку не более, чем на 1/2 ширини дорожки;

различние оттенки обратной сторони поверхности пластин (контролируется визуально).

2.3. Контактние площалки должны быть чистыми и свободными от ващитного окисла.

73900 Wend 94.04

UCI NECOKUM NOON VIOL

HMO.734.029 H2

3

	Лист р Нам <b>ера лист</b> ов			егистрации)		изменений Всего,				i i
		изменён	Заменён Ных	новых	ниц) изъятых	пиство (странии) в дакум,	№ докум,	Вхадящий м° сопрово дительно- го докумен та и дата	ນອອກ	Дата
									Total	
							**************************************			
dama						4.84				
0 <u>011 U B</u>										
					, j					
No Marie							T. 19 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			
Barn und N										
Same of the same o										
Co Jan										
A READING							0.734.029			Лист